PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-309013

(43)Date of publication of application: 23.10.2002

(51)Int.CI.

COSJ 5/18 G02F 1/1368 G09F 9/30 G09F 9/35 H01B H01B 7/02 H01B 13/00 H01L 21/28 H01L 21/283 H01L 29/786 H01L 51/00 // C08L101:00

(21)Application number: 2001-386590

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

19.12.2001

(72)Inventor:

OGAWA KAZUFUMI

MINO NORIHISA

YAMAMOTO SHINICHI

(30)Priority

Priority number : 2000395701

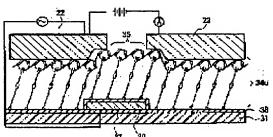
Priority date: 26.12.2000

Priority country: JP

(54) CONDUCTIVE ORGANIC THIN FILM AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME, AND ELECTRONIC DEVICE, ELECTRIC CABLE, ELECTRODE, PYRROLYL COMPOUND AND THIENYL COMPOUND USING THE CONDUCTIVE ORGANIC THIN FILM

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a conductive organic thin film having the same or higher conductivity as or than that of a conductive metal such as gold or silver, to provide a method for producing the conductive organic thin film, and to provide a device or the like using the conductive organic thin film. SOLUTION: This conductive organic thin film is characterized in that one of organic molecules 34c contains a terminal bonding group covalently bonded to the surface of a substrate 38, a conjugated bond group existing at either portion of the organic molecule and polymerized with another molecule, and an active hydrogen-free polar functional group at any portion between the terminal bonding group and the conjugated bond group, wherein the organic molecules are arranged and the conjugated bond groups are polymerized to form a conductive network 35. The conductive organic thin film preferably has a conductivity (p) of ≥1 × 107 S/cm in a dopant-free state at room temperature (25° C). Especially. an electrolytic oxidation-polymerized polypyrrole or polythienylene conjugated bond film has high conductivity.



LEGAL STATUS

Date of request for examination

19.12.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3569257

[Date of registration]

25.06.2004

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-309013 (P2002-309013A)

(43)公開日 平成14年10月23日(2002.10.23)

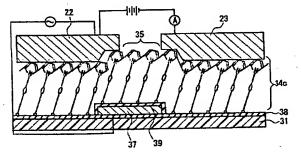
									'* (da.#s)
(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ		,		•	71-1 (多考)
C08J	5/18	CEZ		C 0	8 J	5/18		CEZ	2H092
G02F	1/1368			G 0	2 F	1/1368			4F071
G09F	9/30	338		G 0	9 F	9/30		338	4M104
,0001	0,00	365						365Z	5 C O 9 4
	9/35	000				9/35			5F110
	9/30		審査請求	有	朱龍	項の数38	OL	(全 26 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願2001-386590(P200	01 - 386590)	(71) 出願人 000005821 松下電器産業株式会社					
(22)出顯日		平成13年12月19日(2001	. 12. 19)	大阪府門真市大字門真1006番地 (72)発明者 小川 一文					審地
(31)優先権主張番号 (32)優先日		特顧2000-395701 (P20 平成12年12月26日 (2000		大阪府門真市大字門真1006番地 松下 産業株式会社内					番地 松下電器
(33)優先権主張国		日本 (JP))発明者	大阪府		大字門真1006 :内	6番地 松下電器
				(74)代理人 110000040 特許業務法人池内・佐藤アンド					
									最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 導電性有機轉膜とその製造方法、それを用いた電子デバイス、電気ケーブル、電極、ピロリル化 合物及びチェニル化合物

(57)【要約】

【課題】金や銀などの導電性金属と同等かまたはそれ以上の導電性を有する導電性有機薄膜とその製造方法及び これを用いたデバイス等を提供する。

【解決手段】有機分子34cの一方の末端が基材38表面と 共有結合した末端結合基と、前記有機分子のいずれかの 部分に存在し、他の分子と重合した共役結合基と、前記 末端結合基と前記共役結合基との間のいずれかの部分 に、活性水素を含まない有極性官能基を含み、前記有機 分子は配向しており、かつ、前記共役結合基は重合して ポリマー化しており、導電ネットワーク35を形成してい る。導電性有機薄膜の電導度(ρ)は、室温(25℃) においてドーパントなしで好適には1×10′S/cm 以上である。とくに電解酸化重合させたポリビロールま たはポリチェンレン共役結合の膜は高い導電性を有す る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 有機分子の一方の末端が基材表面と共有 結合した末端結合基と、

前記有機分子のいずれかの部分に存在し、他の分子と重 合した共役結合基と、

前記末端結合基と前記共役結合基との間のいずれかの部 分に、活性水素を含まない有極性官能基を含み、

前記有機分子は配向しており、かつ、前記共役結合基は 他の分子の共役結合基と重合して導電ネットワークを形 成していることを特徴とする導電性有機薄膜。

【請求項2】 重合が、電解酸化重合、触媒重合および エネルギービーム照射重合から選ばれる少なくとも一つ である請求項1に記載の導電性有機薄膜。

【請求項3】 最終段階の重合が電解酸化重合である請 求項2に記載の導電性有機薄膜。

【請求項4】 前記導電性有機薄膜の電導度(ρ)が、 室温 (25°C) においてドーパントなしで1S/cm以 上である請求項1に記載の導電性有機薄膜。

【請求項5】 前記導電性有機薄膜の電導度(ρ)が、 室温(25°C)においてドーパントなしで1×10°S /cm以上である請求項4に記載の導電性有機薄膜。

【請求項6】 前記導電性有機薄膜の電導度(ρ)が、 室温(25℃)においてドーパントなしで5.5×10 'S/cm以上である請求項5に記載の導電性有機薄 贖.

【請求項7】 前記導電性有機薄膜の電導度(ρ)が、 室温(25°C)においてドーパントなしで1×10'S /cm以上である請求項6に記載の導電性有機薄膜。

【請求項8】 前記重合した共役結合基が、ポリピロー ル、ポリチェニレン、ポリアセチレン、ポリジアセチレ ン及びポリアセンから選ばれる少なくとも一つの共役結 合基である請求項1に記載の導電性有機薄膜。

【請求項9】 前記活性水素を含まない有極性官能基 が、エステル基(-СОО-)、オキシカルボニル基 (-OCO-)、カルボニル基(-CO-)及びカーボ ネイト(-OCOO-)基から選ばれる少なくとも一つ の基である請求項1に記載の導電性有機薄膜。

【請求項10】 前記末端結合基が、シロキサン(- S iO-)及び-SiN-結合から選ばれる少なくとも一 合基があっても良い。) である請求項1に記載の導電性 有機薄膜。

【請求項11】 前記分子の配向が、ラビングによる配 向処理、脱離反応によって基材表面に分子を共有結合し た後の反応溶液からの傾斜液切り処理、偏光の照射処 理、及び重合時の分子のゆらぎによる配向から選ばれる 少なくとも一つによって形成されている請求項1に記載 の導電性有機薄膜。

【請求項12】 前記有機薄膜の導電領域が可視領域の 波長を有する光に対して透明である請求項1に記載の導 50 及び脱イソシアネート反応から選ばれる少なくとも一つ

電性有機薄膜。

【請求項13】 前記導電ネットワークを形成している 分子ユニットが下記化学式(1)または(2)で示され る請求項1に記載の導電性有機薄膜。

2

[161]

$$X - \{CH_2\}_q - \{CH_2\}_q - Z - \{CH_2\}_q - Si\{-0-\}_p \in {}_{3-p}$$

[1₂]

10

(但し、前記化学式(1)及び(2)において、Xは水 素、または不飽和基を含む有機基、qは0~10の整 数、乙はエステル基(-COO-)、オキシカルボニル 基(-000-)、カルボニル基(-00-)またはカ ーボネイト(-OCOO-)基、Eは水素または炭素数 1-3のアルキル基、m、nは整数でありm+nは2以 20 上25以下、好ましくは10以上20以下の整数、pは 整数であり、1、2又は3である。)

【請求項14】 基板に共有結合している基と、前記基 板表面に沿った方向にボリマー化している導電性ネット ワークを形成している導電性有機薄膜であって、前記導 電性ネットワークはポリピロール及びポリチェニレンか ら選ばれる少なくとも一つのポリマーであり、前記導電 性有機薄膜の電導度(p)が、室温(25℃)において ドーパントなしで1×10'S/cm以上である導電性 有機薄膜。

【請求項15】 有機分子の一方の末端が基材表面と共 有結合可能な末端官能基と、

前記有機分子のいずれかの部分に存在し、他の分子と重 合可能な共役結合可能基と、

前記末端結合基と前記共役結合基との間のいずれかの部 分に、活性水素を含まない有極性官能基を含む分子から なる化合物を、表面に活性水素を有するか又は活性水素 を付与した基材上に接触させ、脱離反応により共有結合 させて有機薄膜を成膜し、

前記有機薄膜を構成する有機分子を所定の方向に傾斜し つの結合(但し、Si及びNには価数に相当する他の結 40 て配向させるか、または次の重合工程で配向させながら

> 重合工程においては、前記共役結合可能基同士を電解酸 化重合、触媒重合およびエネルギービーム照射重合から 選ばれる少なくとも一つの重合法により共役結合させて 導電ネットワークを形成する導電性有機薄膜の製造方

> 【請求項16】 前記末端官能基が、ハロゲン化シリル 基、アルコシリル基またはイソシアネート基であり、基 材表面の活性水素と脱塩化水素反応、脱アルコール反応

の脱離反応によって共有結合を形成する請求項15に記 載の導電性有機薄膜の製造方法。

【請求項17】 前記共役結合可能基が、ピロリル基、 チェニル基、アセチレン基を含むエチニル基及びジアセ チレン基を含むジエチニル基から選ばれる少なくとも一 つの基である請求項15に記載の導電性有機薄膜の製造 方法。

【請求項18】 前記活性水素を含まない有極性官能基 が、エステル基 (-COO-)、オキシカルボニル基 (-OCO-)、カルボニル基(-CO-)及びカーボ 10 ネイト(-0000-) 基から選ばれる少なくとも一つ の基である請求項15に記載の導電性有機薄膜の製造方

$$x - (CH_2)_{\alpha} = -(CH_2)_{\alpha} z - (CH_2)_{\alpha} SI_{\alpha}E_{2+\alpha}$$

[1k4]

(但し、前記式(3)及び(4)において、Xは水素、 または不飽和基を含む有機基、 q は0~10の整数、 Z はエステル基 (-COO-)、オキシカルボニル基 (-〇〇〇一)、カルボニル基(一〇〇一)またはカーボネ イト(-OCOO-)基、Dはハロゲン原子、イソシア ネート基又は炭素数1-3のアルコキシル基、Eは水素 または炭素数1-3のアルキル基、m、nは整数であり m+nは2以上25以下、好ましくは10以上20以下 の整数、pは整数であり、1、2又は3である。)

【請求項22】 前記有機分子は単分子層状に形成され ている請求項15に記載の導電性有機薄膜の製造方法。 【請求項23】 前記単分子層形成工程を複数回繰り返 すことにより、単分子層を積層させて単分子累積膜を形 成する請求項22に記載の導電性有機薄膜の製造方法。

【請求項24】 前記単分子層形成工程と前記傾斜処理 工程とを交互に繰り返し行った後、前記導電ネットワー ク形成工程で、単分子累積膜の各単分子層内に導電ネッ トワークを一括形成することにより、導電性単分子累積 膜を形成する請求項23に記載の導電性有機薄膜の製造 方法。

【請求項25】 前記単分子層形成工程、前記傾斜処理 工程及び前記導電ネットワーク形成工程を繰り返し行う ことにより、導電性単分子累積膜を形成する請求項15 に記載の導電性有機薄膜の製造方法。

【請求項26】 前記エネルギービームが、紫外線、遠 紫外線、X線及び電子線から選ばれる少なくとも一つで ある請求項15に記載の導電性有機薄膜の製造方法。

【請求項27】 前記エネルギービームが、偏光した紫 外線、偏光した遠紫外線及び偏光したX線から選ばれる 少なくとも一つであり、前記傾斜配向処理と前記導電ネ ットワーク形成とを同時に行う請求項26に記載の導電 50 記第1の電極と離隔した第2の電極と、

*【請求項19】 重合工程の最終段階においては、電解 酸化重合により導電ネットワークを完結させる請類1 5 に記載の導電性有機薄膜の製造方法。

【請求項20】 前記分子の配向を ラビングによる配 向処理、脱離反応によって基材表面に分子を共有給し た後の反応溶液からの傾斜液切り処理、偏光の照線 理、及び重合時の分子のゆらぎによる配向から選ばる 少なくとも一つの処理によって行う請求項15に識の 導電性有機薄膜の製造方法。

【請求項21】 前記有機分子が下記化学式(3)また は(4))で示される請求項15に記載の導電性機薄 膜の製造方法。

[1Ł3]

性有機薄膜の製造方法。

【請求項28】 前記導電ネットウーク形成中まな状形 成後に、さらにドーパントを添加する請求項15に記載 の導電性有機薄膜の製造方法。

【請求項29】 基板上に形成された第1の電極と、前 記第1の電極と離隔した第2の電極と、前記第10電極 と第2の電極とを電気的に接続する導電性有機薄膜とを 備えた2端子有機電子デバイスであって、

前記導電性有機薄膜は、有機分子の一方の末端が基材表 面と共有結合した末端結合基と、前記有機分子のいずれ かの部分に存在し、他の分子と重合した共役結合基と、 前記末端結合基と前記共役結合基との間のいずれかの部 分に、活性水素を含まない有極性官能基を含み、前記有 機分子は配向しており、かつ、前記共役結合基は重合し て導電ネットワークを形成していることを特徴とする2 端子有機電子デバイス。

【請求項30】 基板上に形成された第1の電極と、前 記第1の電極と離隔した第2の電極と、前記第1の電極 と第2の電極とを電気的に接続する導電性有機薄膜と、 前記基板と前記導電性有機薄膜との間に挟まれ、それぞ れと絶縁されている第3の電極と、を備えた3端子有機 電子デバイスであって、

前記第3の電極は、前記第1の電極又は前記第2の電極 との電極間に電圧を印加することにより前記導電性有機 薄膜に作用させる電界を制御する電極であり、

前記導電性有機薄膜は、有機分子の一方の末端が基材表 面と共有結合した末端結合基と、前記有機分子のいずれ かの部分に存在し、他の分子と重合した共役結合基と、 前記末端結合基と前記共役結合基との間のいずれかの部 分に、活性水素を含まない有極性官能基を含み、前記有 機分子は配向しており、かつ、前記共役結合基は重合し て導電ネットワークを形成していることを特徴とする3 端子有機電子デバイス。

【請求項31】 基板上に形成された第1の電極と、前

有機分子の一方の末端が基材表面と共有結合した末端結 合基と、前記有機分子のいずれかの部分に存在し、他の 分子と重合した共役結合基と、前記末端結合基と前記共 役結合基との間のいずれかの部分に、活性水素を含まな い有極性官能基を含み、前記有機分子は配向しており、 かつ、前記共役結合基は重合して導電ネットワークを形 成している導電性有機薄膜を介して、前記第1の電極と 前記第2の電極とを電気的に接続し、前記基板と前記導 電性有機薄膜との間に挟まれ、かつそれぞれと絶縁され ており、前記第1又は第2の電極との間に印加される電 10 圧により前記導電性有機薄膜に作用させる電界を制御す る第3の電極とを備えた3端子有機電子デバイスをスイ ッチ素子として用いた液晶表示装置であって、

5

前記基板上に複数の前記スイッチ素子がマトリックス状 に配列配置されたアレイ基板と、

前記アレイ基板表面に形成された第1の配向膜と、

透明基板上に色要素がマトリックス状に配列配置された カラーフィルター基板と、

前記カラーフィルター基板表面に形成された第2の配向 膜と、

前記第1の配向膜と前記第2の配向膜とを内側にして対 向させた前記アレイ基板と前記カラーフィルター基板と の間に封止された液晶層とを有することを特徴とする液 晶表示装置。

【請求項32】 基板上に形成された第1の電極と、前 記第1の電極と離隔した第2の電極と、

有機分子の一方の末端が基材表面と共有結合した末端結 合基と、前記有機分子のいずれかの部分に存在し、他の 分子と重合した共役結合基と、前記末端結合基と前記共 役結合基との間のいずれかの部分に、活性水素を含まな 30 水素を含まない有極性官能基を含み、前記有機分子は配 い有極性官能基を含み、前記有機分子は配向しており、 かつ、前記共役結合基は重合して導電ネットワークを形 成している導電性有機薄膜を介して、前記第1の電極と 前記第2の電極とを電気的に接続し、

前記基板と前記導電性有機薄膜との間に挟まれ、かつそ れぞれと絶縁されており、前記第1又は第2の電極との 間に印加された電圧により前記導電性有機薄膜に作用さ せる電界を制御する第3の電極と、

を備えた3端子有機電子デバイスをスイッチ素子として 用いたエレクトロルミネッセンス型表示装置であって、 複数の前記スイッチ素子が基板上にマトリックス状に配 列配置されたアレイ基板と、

前記アレイ基板と対向する共通電極と、

前記アレイ基板と前記共通電極との間に形成された、電 界の印加により発光する蛍光物質を含む発光層とを有す ることを特徴とするエレクトロルミネッセンス型表示装

【請求項33】 可視光線領域の光波長では透明な電極 であって、

合した末端結合基と、前記有機分子のいずれかの部分に 存在し、他の分子と重合した共役結合基と、前記末端結 合基と前記共役結合基との間のいずれかの部分に、活性 水素を含まない有極性官能基を含み、前記有機分子は配 向しており、かつ、前記共役結合基は重合して導電ネッ トワークを形成している導電性有機薄膜で形成されてい ることを特徴とする電極。

【請求項34】 芯線と、前記芯線の表面の長さ方向に 形成されている導電性有機薄膜と、前記導電性有機薄膜 を覆う絶縁被膜とを備えた電気ケーブルであって、

前記導電性有機薄膜は、有機分子の一方の末端が芯線の 基材表面と共有結合した末端結合基と、前記有機分子の いずれかの部分に存在し、他の分子と重合した共役結合 基と、前記末端結合基と前記共役結合基との間のいずれ かの部分に、活性水素を含まない有極性官能基を含み、 前記有機分子は配向しており、かつ、前記共役結合基は 重合して導電ネットワークを形成していることを特徴と する電気ケーブル。

【請求項35】 前記電気ケーブルは互いに電気的に絶 20 縁された複数本の芯線を含む集合電線を形成している請 求項34に記載の電気ケーブル。

【請求項36】 芯線がガラスまたは金属である請求項 34に記載の電気ケーブル。

【請求項37】 可視光線領域の光波長では透明な電極 であって、

前記電極は、有機分子の一方の末端が基材表面と共有結 合した末端結合基と、前記有機分子のいずれかの部分に 存在し、他の分子と重合した共役結合基と、前記末端結 合基と前記共役結合基との間のいずれかの部分に、活性 向しており、かつ、前記共役結合基は重合して導電ネッ トワークを形成している導電性有機薄膜であることを特 徴とする電極。

下記化学式(5)または(6)で示さ 【請求項38】 れるピロリル化合物またはチェニル化合物。

$$X - (CH_2) = X - (CH_2) = X - (CH_2) = SipE_3 - CH_2$$

[(£6]

40

$$X - (CH_2)^{\frac{1}{6}} \sqrt{(CH_2)^{\frac{1}{6}}} Z - (CH_2)^{\frac{1}{6}} Si_{p}E_{2-p}$$

(但し、前記式(5)及び(6) において、Xは水素、 または不飽和基を含む有機基、 q は0~10の整数、 Z はエステル基(-СОО-)、オキシカルボニル基(-〇〇〇-)、カルボニル基(-〇〇-)またはカーボネ イト (-OCOO-) 基、Dはハロゲン原子、イソシア ネート基又は炭素数1-3のアルコキシル基、Eは水素 または炭素数1-3のアルキル基、m、n は整数であり 前記電極は、有機分子の一方の末端が基材表面と共有結 50 m+nは2以上25以下、好ましくは10以上20以下

の整数、 p は整数であり、 1 、 2 又は 3 である。) 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、有機材料を用いた 導電性有機薄膜とその製造方法、それを用いた有機電子 デバイス、液晶表示装置、エレクトロルミネッセンス装 置、電気ケーブル電極、ピロリル化合物及びチェニル化 合物に関するものである。さらには、導電性を有する単 分子膜又は単分子累積膜または薄膜の導電性変化を利用 した有機電子デバイスと表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来から有機導電膜については様々な提案がある。本出願人は、すでにポリアセチレン、ポリシアセチレン、ポリアセン(Polyacene)、ポリフェニレン、ポリチェニレン、ポリピロール、ポリアニリンなどの導電性共役基を含む導電膜を提案している(特開平2(1990)-27766号公報、USP5,008,127、EP-A-0385656、EP-A-0339677、EP-A-0552637、USP5,270,417、特開平5(1993)-87559号公報、特開平6(1994)-242352号公報)。

【0003】また、従来から電子デバイスには、シリコ 20 ン結晶に代表されるように無機系の半導体材料が用いられている。有機系の電子デバイス(以下、有機電子デバイス)としては、例えば日本国特許第2034197号及び第2 507153号等に開示されている。これら各公報に記載されている有機電子デバイスは、印加された電界に応答し端子間に流れる電流をスイッチングする有機電子デバイスである。

【0004】前記従来の有機系導電膜は、導電性が金属に比較すると低いという問題があった。また、従来から用いられてきた無機結晶では、微細化が進展するに伴い 30 結晶欠陥が問題となり、デバイス性能が結晶に大きく左右される問題があった。また、フレキシビリティーが悪いという問題があった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記に鑑みなされたものであり、その第1番目の目的は、従来の有機 導電膜よりも高い導電性を有するか、または金や銀など の導電性金属と同等かまたはそれ以上の導電性を有する 導電性有機薄膜とその製造方法を提供することにある。

【0006】本発明の第2番目の目的は、デバイスの高 40 密化が進展し0.1 μ m以下の微細加工がなされても、結晶性に左右されない有機物質を用いたデバイスを作製し、高集積化されたデバイスを提供することにある。また、プラスチック基板等に形成することにより、フレキシビリティーに優れた有機電子デバイスを提供することにある。

【0007】本発明の第3番目の目的は、前記導電性有機薄膜に有用なピロリル化合物及びチェニル化合物を提供することである。

[0008]

8

【課題を解決するための手段】前記目的を達成する。 め、本発明の導電性有機薄膜は、有機分子の一方の結構が基材表面と共有結合した末端結合基と、前記有機分子のいずれかの部分に存在し、他の分子と重合した地結合基と、前記末端結合基と前記共役結合基との間のいずれかの部分に、活性水素を含まない有極性官能基を含み、前記有機分子は配向しており、かつ、前記共健協合基は他の分子の共役結合基と重合して導電ネットワークを形成していることを特徴とする。

【0009】次に本発明の別の導電性有機薄膜は、基板に共有結合している基と、前記基板表面に沿った方向にポリマー化している導電性ネットワークを形成している導電性有機薄膜であって、前記導電性ネットワーがポリピロール及びポリチェニレンから選ばれる少なくとも一つのポリマーであり、前記導電性有機薄膜の電響(ρ)が、室温(25℃)においてドーバントなして1×10′S/cm以上であることを特徴とする。

【0010】次に本発明の導電性有機薄膜の製造方法は、有機分子の一方の末端が基材表面と共有結合可能な末端官能基と、前記有機分子のいずれかの部分に存在し、他の分子と重合可能な共役結合可能基と、前記末端結合基と前記共役結合基との間のいずれかの部分に、活性水素を含まない有極性官能基を含む分子からなる化合物を、表面に活性水素を有するか又は活性水素を付与した基材上に接触させ、脱離反応により共有結合させて有機薄膜を成膜し、前記有機薄膜を構成する有機分子を所定の方向に傾斜して配向させるか、または次の重合工程で配向させながら重合し、重合工程においては、前記共役結合可能基同士を電解酸化重合、触媒重合およびエネルギービーム照射重合から選ばれる少なくとも一つの重合法により共役結合させて導電ネットワークを形成することを特徴とする。

【0011】次に本発明の3端子有機電子デバイスは、 基板上に形成された第1の電極と、前記第1の電極と離 隔した第2の電極と、前記第1の電極と第2の電極とを 電気的に接続する導電性有機薄膜と、前記基板と前記導 電性有機薄膜との間に挟まれ、それぞれと絶縁されてい る第3の電極と、を備えた3端子有機電子デバイスであ って、前記第3の電極は、前記第1の電極又は前記第2 の電極との電極間に電圧を印加することにより前記導電 性有機薄膜に作用させる電界を制御する電極であり、前 記導電性有機薄膜は、有機分子の一方の末端が基材表面 と共有結合した末端結合基と、前記有機分子のいずれか の部分に存在し、他の分子と重合した共役結合基と、前 記末端結合基と前記共役結合基との間のいずれかの部分 に、活性水素を含まない有極性官能基から選ばれる少な くとも一つの基を含み、前記有機分子は配向しており、 かつ、前記共役結合基は重合して導電ネットワークを形で 成していることを特徴とする。

50 【0012】次に本発明の液晶表示装置は、基板上に形

成された第1の電極と、前記第1の電極と離隔した第2 の電極と、有機分子の一方の末端が基材表面と共有結合 した末端結合基と、前記有機分子のいずれかの部分に存 在し、他の分子と重合した共役結合基と、前記末端結合 基と前記共役結合基との間のいずれかの部分に、活性水 素を含まない有極性官能基を含み、前記有機分子は配向 しており、かつ、前記共役結合基は重合して導電ネット ワークを形成している導電性有機薄膜を介して、前記第 1の電極と前記第2の電極とを電気的に接続し、前記基 板と前記導電性有機薄膜との間に挟まれ、かつそれぞれ と絶縁されており、前記第1又は第2の電極との間に印 加される電圧により前記導電性有機薄膜に作用させる電 界を制御する第3の電極と、を備えた3端子有機電子デ バイスをスイッチ素子として用いた液晶表示装置であっ て、前記基板上に複数の前記スイッチ素子がマトリック ス状に配列配置されたアレイ基板と、前記アレイ基板表 面に形成された第1の配向膜と、透明基板上に色要素が マトリックス状に配列配置されたカラーフィルター基板 と、前記カラーフィルター基板表面に形成された第2の 配向膜と、前記第1の配向膜と前記第2の配向膜とを内 20 側にして対向させた前記アレイ基板と前記カラーフィル ター基板との間に封止された液晶層とを有することを特 徴とする。

【0013】次に本発明のエレクトロルミネッセンス型 表示装置は、基板上に形成された第1の電極と、前記第 1の電極と離隔した第2の電極と、有機分子の一方の末 端が基材表面と共有結合した末端結合基と、前記有機分 子のいずれかの部分に存在し、他の分子と重合した共役 結合基と、前記末端結合基と前記共役結合基との間のい ずれかの部分に、活性水素を含まない有極性官能基を含 み、前記有機分子は配向しており、かつ、前記共役結合 基は重合して導電ネットワークを形成している導電性有 機薄膜を介して、前記第1の電極と前記第2の電極とを 電気的に接続し、前記基板と前記導電性有機薄膜との間 に挟まれ、かつそれぞれと絶縁されており、前記第1又 は第2の電極との間に印加された電圧により前記導電性 有機薄膜に作用させる電界を制御する第3の電極とを備 えた3端子有機電子デバイスをスイッチ素子として用い たエレクトロルミネッセンス型表示装置であって、複数 の前記スイッチ素子が基板上にマトリックス状に配列配 40 置されたアレイ基板と、前記アレイ基板と対向する共通 電極と、前記アレイ基板と前記共通電極との間に形成さ れた、電界の印加により発光する蛍光物質を含む発光層 とを有することを特徴とする。

【0014】次に本発明の電気ケーブルは、芯線と、前記芯線の表面の長さ方向に形成されている導電性有機薄膜と、前記導電性有機薄膜を覆う絶縁被膜とを備えた電気ケーブルであって、前記導電性有機薄膜は、有機分子の一方の末端が芯線の基材表面と共有結合した末端結合基と、前記有機分子のいずれかの部分に存在し、他の分

子と重合した共役結合基と、前記末端結合基と前記共役 結合基との間のいずれかの部分に、活性水素を含まない 有極性官能基を含み、前記有機分子は配向しており、か つ、前記共役結合基は電解酸化重合により重合して導電 ネットワークを形成していることを特徴とする。

【0015】次に本発明の電極は、可視光線領域の光波 長では透明な電極であって、前記電極は、有機分子の一 方の末端が基材表面と共有結合した末端結合基と、前記 有機分子のいずれかの部分に存在し、他の分子と重合し た共役結合基と、前記末端結合基と前記共役結合基との 間のいずれかの部分に、活性水素を含まない有極性官能 基を含み、前記有機分子は配向しており、かつ、前記共 役結合基は重合して導電ネットワークを形成している導 電性有機薄膜であることを特徴とする。

【0016】次に本発明の導電性ネットワークは、下記化学式(7)または(8)で示される。

[0017]

[(127)

$$X - (CH_2) = X - (CH_2) = Z - (CH_2) = Si(-0-), E_3-P$$

[0018]

【化8】

$$X - (CH_2) \frac{1}{\sigma} Z - (CH_2) \frac{1}{\sigma} Si(-0-) PE _{3-P}$$

【0019】(但し、前記化学式(7)及び(8)において、Xは水素、または不飽和基を含む有機基、qは0~10の整数、Zはエステル基(-COO-)、オキシカルボニル基(-OCO-)、カルボニル基(-CO-)またはカーボネイト(-OCOO-)基、Eは水素または炭素数1-3のアルキル基、m、nは整数でありm+nは2以上25以下、好ましくは10以上20以下の整数、pは整数であり、1、2又は3である。)次に本発明の化合物は、下記化学式(9)または(10)で示される。

[0020]

[{£9]

$$X - (CH_2) = N - (CH_2) = Z - (CH_2) = SipE_3 - N$$

[0021]

【化10】

【0022】(但し、前記式(9)及び(10)において、Xは水素、または不飽和基を含む有機基、qは0~10の整数、Zはエステル基(-COO-)、オキシカルボニル基(-COO-)、カルボニル基(-CO-) またはカーボネイト(-OCOO-)基、Dはハロゲン

原子、イソシアネート基又は炭素数1-3のアルコキシル基、Eは水素または炭素数1-3のアルキル基、m、nは整数でありm+nは2以上25以下、好ましくは10以上20以下の整数、pは整数であり、1、2又は3である。)

[0023]

【発明の実施の形態】本発明において、有機薄膜が導電性を有するのは、有機分子の集合群を構成する分子相互が共役結合してポリマー化していることによる。ここに、導電ネットワークは、電気伝導に関与する共役結合 10で結合した有機分子の集合体であり、共役結合鎖(共役系)を有するポリマーで形成されている。また、導電ネットワークは電極間の方向に形成されている。この共役結合鎖ポリマーは厳密に1方向に連なるものではなく、様々な方向のポリマー鎖が、全体として電極間に形成されていればよい。

【0024】本発明においては、導電性有機薄膜の電導度 (ρ) は、1 S/c m以上、好ましくは 1×1 0° S/c m以上、さらに好ましくは 1×1 0° S/c m以上であり、さらに 5×1 0° S/c m以上、特に好ましくは 1×1 0° S/c m以上である。前記の値はすべて室温(25 °C)におけるドーパントなしの場合である

【0025】前記重合した共役結合基は、ポリビロール、ポリチェニレン、ポリアセチレン、ポリジアセチレン及びポリアセンから選ばれる少なくとも一つの共役結合基であることが好ましい。とくに共役結合が、ポリビロールまたはポリチェニレンであり、電解酸化重合させた薄膜は高い電導度を有する。

【0026】前記活性水素を含まない有極性官能基は、エステル基(-COO-)、オキシカルボニル基(-OCO-)、カルボニル基(-CO-)及びカーボネイト(-OCOO-)基から選ばれる少なくとも一つの基であることが好ましい。

【0027】前記末端結合基は、シロキサン(-SiO-)及び-SiN-結合から選ばれる少なくとも一つの結合であることが好ましい。

【0028】前記末端結合基は、脱塩化水素反応、脱アルコール反応及びから選ばれる少なくとも一つの脱離反応によって形成されていることが好ましい。

【0029】この方法によって形成される分子膜は、当業界では"化学吸着膜"または"セルフアセンブル(selfassemble)膜"と言われているが、本発明においては"化学吸着膜"と呼ぶ。また、その形成方法を"化学吸着法"と呼ぶ。

【0030】本発明において、分子の配向は、ラビングによる配向処理、脱離反応によって基材表面に分子を共有結合した後の反応溶液からの傾斜液切り処理、偏光の照射処理、及び重合工程における分子のゆらぎによる配向から選ばれる少なくとも一つによって形成されている 50

ことが好ましい。

【0031】前記有機薄膜の導電領域は可視領域の液長を有する光に対して透明であることが好ましい。

【0032】前記導電ネットワークを形成している分子 ユニットは例えば下記式(11)または(12)で示さ れることが好ましい。

[0033]

[{{t}11]

$$X - (CH_2)_0$$
 $N - (CH_2)_0 = Z - (CH_2)_0 Si(-0-)_0 E_{3-0}$

[0034]

[ft12]

【0035】(但し、前記式(11)及び(12)において、Xは水素、または不飽和基を含む有機基、qは020~10の整数、Zはエステル基(-COO-)、オキシカルボニル基(-OCO-)、カルボニル基(-CO-)またはカーボネイト(-OCOO-)基、Dはハロゲン原子、イソシアネート基又は炭素数1-3のアルコキシル基、Eは水素または炭素数1-3のアルキル基、m、nは整数でありm÷nは2以上25以下、好ましくは10以上20以下の整数、pは整数であり、1、2又は3である。)

【0037】前記有機分子は単分子層状に形成されていることが好ましい。

れる少なくとも一つの基であっても良い。

【0038】また、前記単分子層形成工程を複数回繰り返すととにより、単分子層を積層させて単分子累積膜を40 形成しても良い。

【0039】前記化学式EまたはFにおいて、Xがビニル結合などの不飽和基を含む場合は、例えば水分の存在する雰囲気中で電子線またはX線などのエネルギー線を照射することにより-OH基を導入できる。また、Xがビニル結合などの不飽和基を含む場合は、例えば過マンガン酸カリウム水溶液に浸漬することにより-COOHを導入できる。とのようにすると、活性水素を導入できるので、さらに単分子膜を累積結合させることができる

0 【0040】また、前記単分子層形成工程と前記傾斜処

理(配向)工程とを交互に繰り返し行った後、前記導電 ネットワーク形成工程で、単分子累積膜の各単分子層内 に導電ネットワークを一括形成することにより、導電性 単分子累積膜を形成しても良い。

13

【0041】また、前記単分子層形成工程、前記傾斜処 理工程及び前記導電ネットワーク形成工程よりなる一連 の工程を繰り返し行うことにより、導電性単分子累積膜 を形成しても良い。

【0042】重合方法としては、電解酸化重合、触媒重 合及びエネルギー線照射重合から選ばれる少なくとも- 10 つの重合方法がある。前記電解酸化による導電ネットワ ークを形成する前に、触媒重合及びエネルギー線照射重 合から選ばれる少なくとも一つの予備重合を行っても良

【0043】前記エネルギー線は、紫外線、遠紫外線、 X線及び電子線から選ばれる少なくとも一つであること が好ましい。

【0044】前記エネルギー線は、偏光した紫外線、偏 光した遠紫外線及び偏光したX線から選ばれる少なくと も一つであり、前記傾斜配向処理と前記導電ネットワー ク形成とを同時に行っても良い。

【0045】有機分子が有極性の官能基を含むことによ り、印加された電界に対する感度が高く、応答速度が高 速となる。したがって、有機薄膜の導電性を高速に変化 させることができる。電界が印加された際、前記有機薄 膜の導電性の変化は、有極性の官能基が電界に応答し、 その応答による影響が前記導電ネットワークの構造に波 及されたため、生じたと考えられる。

【0046】また、ドーピングにより導電ネットワーク に電荷移動性のドーパント物質の組み込めば、さらに導 30 なっていてもよい。また、すべての単分子層を同一有機 電率を向上することも可能である。このドーパント物質 として、ヨウ素、BF-イオン、Na, K等のアルカリ 金属、Сa等のアルカリ土類金属等の任意のドーパント 物質が利用できる。さらに有機膜形成工程の溶液に含ま れる微量成分やガラス容器などから不可避的に混入され るコンタミネーションによるドーパント物質を含んでい ても良い。

【0047】別な例においては、電界応答型導電性有機 薄膜中に電界が生じると、電界の強度に応じて導電ネッ トワークの導電が変化する。したがって、導電性有機薄 膜に電界が作用していない状態と、所定の強度の電界が 作用している状態とでは、導電ネットワークの導電率が 異なる。したがって、電界のオン・オフ制御により、導 電ネットワークの導電率をスイッチング制御することが できる。

【0048】また、強度の異なる第1の電界又は第2の 電界が有機薄膜に印加されていると、導電ネットワーク の導電率はそれぞれ第1の導電率又は第2の導電率とな る。これにより、第1の導電率を有する安定状態と第2 の導電率を有する安定状態との状態間を状態移行させ

て、導電ネットワークの導電率をスイッチングすること もできる。

【0049】導電単分子層を構成する有機分子はかなり 良く配向した状態にあるため、導電ネットワークの共役 結合鎖が特定平面内に存在する。したがって、単分子層 に形成された導電ネットワークは所定の方向に直線的に 連なる。その導電ネットワークの直線性により、高い導 電異方性を有する。また、その導電ネットワークの直線 性は、導電ネットワークを構成する各共役結合鎖(共役 系)が単分子層内の同一平面で略平行に配列しているこ とを意味する。したがって、導電単分子層は、高い導電 率を有し、且つ、均一な導電率を有する。また、上記導 電ネットワークの直線性により、重合度の高い共役結合 鎖を単分子層に有することとなる。

【0050】別の例によれば、膜厚が薄くても極めて良 好な導電性を有する導電性単分子膜及び導電性単分子累 **積膜を提供できる。また、それらの導電性の変化は極め** て高速である。

【0051】導電性単分子累積膜の場合、各導電性単分 子層に導電ネットワークが形成されているので、単分子 累積膜の導電ネットワークの導電率は、積層された単分 子膜の層数に依存する。したがって、導電単分子層の積 層数を変更することにより所望の導電率を有する導電性 有機薄膜を提供できる。例えば、同一の導電性単分子層 が積層された導電性累積膜であれば、それに含まれる導 電ネットワークの導電率はほぼ比例する。

【0052】導電性単分子累積膜において、すべての単 分子層に形成された導電ネットワークの方向が同一であ る限り、各単分子層ごとに有機分子の配向の傾斜角が異 分子から構成するものでなくとも良い。また、各導電性 単分子層ごとに異なる種類の有機分子から構成された導 電性単分子累積膜であってもよい。

【0053】また、導電性単分子累積膜の場合は、基材 に最近接する導電性単分子層が基材と化学結合で結合さ れていると、耐剥離性等の耐久性に優れる。

【0054】別の例によれば、方向性を有する導電ネッ トワークを備えた電界応答型導電性有機薄膜を製造する **ととができる。一般的に、導電ネットワークの方向は、** 傾斜処理工程を経た有機薄膜を構成した有機分子の傾斜 方向と同一方向となる。方向性を有する導電ネットワー クが形成される限り、有機分子の傾斜方向と同一でなく てもよい。

【0055】 ここに、傾斜処理工程における有機分子の 傾斜方向は、有機分子の長軸を基材表面に射影した線分 の方向を意味する。したがって、基材に対する傾斜角は 同一角度でなくてもよい。

【0056】別の例によれば、単分子層を有する有機薄 膜が成膜できる。更に、単分子層を構成した有機分子の 50 集合群を、傾斜処理工程において、精度よく所定の方向 に傾斜させることができる。一般的には、単分子層を構成した分子を配向させることができる。更にまた、精度よく配向させることができることにより、導電ネットワーク形成工程において、方向性を有する導電ネットワークを簡便に形成できる。

【0057】また、単分子層内の配向した有機分子相互を共役結合させると、重合度が高くかつ直線的に連なる 導電ネットワークが形成できる。また、導電ネットワークの直線性により、均質な導電性単分子層が形成できる。

【0058】別の例においては、前記偏光として可視光 領域の波長を有する偏光を用いる。この例によれば、有 機薄膜を構成した有機分子の剥離や、有機分子自体の破 壊等による有機薄膜の破壊を防止又は抑制できる。

【0059】別の例によれば、ラビング処理を施した基材表面に有機薄膜を成膜すると、その有機薄膜を構成した有機分子は所定の方向に傾斜した状態となる。一般的には、ラビング処理におけるラビング方向と成膜された有機分子の傾斜方向とは同一方向となる。

【0060】前記ラビング処理で用いるラビング布として、ナイロン製又はレーヨン製の布を用いることができる。上記の構成の如くナイロン製又はレーヨン製のラビング布を用いることが、配向の精度を向上させる目的にとって適正である。

【0061】前記導電ネットワーク形成工程で1種以上の重合法を適用し、前記有機薄膜を構成する分子相互を重合により又は重合及び該重合後の架橋により共役結合させて導電ネットワークを形成しても良い。この例によれば、有機分子の前記重合性基を共役結合で連結させ電気伝導を可能にする導電ネットワークを形成できる。重合の種類としては電解酸化重合、触媒重合及びエネルギービームの照射重合から選ばれる少なくと一つの重合法が利用できる。とくに最終工程において、電解酸化重合により導電ネットワークを完結させると、高い導電性を得ることができる。

【0062】また、前記有機薄膜を形成する分子が共役結合で結合する重合性基を複数有する場合、一方の重合性基の重合で形成された高分子に対して、さらに架橋反応を行い他方の重合性基を共役結合させることにより、重合後の構造と異なる構造を有する導電ネットワークを形成できる。この際、重合により形成された高分子の側鎖にある前記他方の重合性基が架橋される。

【0063】例えば、ジアセチレン基を有する有機分子の集合群からなる単分子膜を形成し、その単分子膜に触媒重合を行い、更に、エネルギービーム照射重合により架橋を行うと、極めて高い導電率を有するポリアセン型共役系を含む導電ネットワークを形成することができる。

【0064】前記重合を行う工程で触媒重合法、電解重合法、エネルギービーム重合法よりなる群から選択され 50

る重台法を適用してもよい。 この例によれば、触媒重台性を有する重合性基(以下、触媒重合性基ともいう)を有する有機分子からなる有機薄膜には触媒重合法を適用して、また、電解重合性を有する重合性基(以下、電解重合性基とも略記する)を有する有機分子からなる有機薄膜には電解重合法を適用して、また、エネルギービームの照射により重合する重合性基(以下、エネルギービーム重合性基ともいう)を有する有機分子からなる電機薄膜にはエネルギービーム重合法を適用して、導電ネットワークを形成することができる。 効率よく 導電ネットワークを形成するには、まず触媒重合法及び/又はエネルギービーム重合を行い、最終工程で電解酸化重合により反応を完結させる。

【0065】複数回の架橋工程を採用する場合は、異なる作用による架橋工程の組合せでもよいが、同じ作用であるが反応条件が異なる工程の組合せも含む。例えば、触媒作用による架橋工程後に第1の種類のエネルギービーム照射による架橋工程を行い、さらに第2の種類のエネルギービーム照射による架橋工程を行う等により導電がネットワークを形成してもよい。

【0066】前記導電ネットワーク形成工程で重合法として前記触媒重合法を適用し、前記重合性基としてピロール基、チェニレン基、アセチレン基又はジアセチレン基を有する有機分子の集合群よりなる有機薄膜に導電ネットワークを形成する。

【0067】例えば、ピロール基を含む有機分子を用いてポリピロール型共役系を含む導電ネットワークを形成でき、チェニレン基を含む有機分子を用いてポリチェニレン型共役系を含む導電ネットワークを形成できる。

【0068】前記導電ネットワーク形成工程で前記エネルギービーム重合法を適用し、前記重合性基としてアセチレン基又はジアセチレン基を有する有機分子の集合群からなる前記有機薄膜に導電ネットワークを形成することもできる。この例によれば、有機薄膜を構成する有機分子として、アセチレン基を有する有機分子を用いて、ボリアセチレン型共役系を含む導電ネットワークを形成できる。また、ジアセチレン基を有する有機分子を用いて、ボリジアセチレン型共役系又はボリアセン型共役系を含む導電ネットワークを形成できる。

【0069】前記エネルギービームとして紫外線、遠紫外線、X線又は電子線を用いてもよい。この例によれば、効率よく導電ネットワークを形成することができる。また、エネルギービーム照射重合性基の種類によりそれぞれ吸収特性は異なるので、吸収効率の良いエネルギービームの種類及びエネルギーを選択すれば反応効率を向上できる。更に、多くのエネルギービーム照射重合性基がこれらのエネルギービームに対し吸収性を有する為、様々な種類のビーム照射重合性基を有する有機分子からなる有機薄膜に適用できる。

└ 【0070】また、前記エネルギービームとして偏光し

た紫外線、偏光した遠紫外線又は偏光したX線を用い、 前記傾斜処理工程と前記導電ネットワーク形成工程とを 同時に行うこともできる。との例によれば、有機薄膜を 構成する有機分子を所定の方向に傾斜(配向)させると ともに、有機分子相互を共役結合させることができる。 したがって、工程を簡素化できる。

【0071】第1の電極と第2の電極とが導電ネットワ ークの方向に配列配置されていると対電極間の導電率が 最も大きくなり、導電ネットワークの方向と直交するよ うに配列配置されていると導電率が最も小さくなる。最 10 大の導電率を有する状態に第1の電極と第2の電極とを 形成すれば、導電率の変化域が大きな3端子有機電子デ バイスを提供できる。

【0072】対電極間の配列方向を調整して、第1の電 極と第2の電極とを配置すれば、電極間の導電率を調整 できる。また、電極の大きさの調整や、対電極間の距離 の調整により、導電率の変化域を調整することもでき る。

【0073】本発明の3端子有機電子デバイスによれ ば、第1の電極と第2の電極とを電気的に接続するチャ ネル部が導電性有機薄膜で形成され、電界の印加により 第1の電極と第2の電極との電極間(対電極間)の導電 **率が変化する3端子有機電子デバイスを提供できる。ま** た、導電性薄膜を構成する有機分子が有極性の官能基を 有することにより、印加された電界に対する感度が高 く、応答速度が高速である。したがって、対電極間の導 電率の変化速度が高速である3端子有機電子デバイスを 提供できる。

【0074】第1の電極と第2の電極とが導電ネットワ も大きくなり、導電ネットワークの方向と直交する方向 に配列配置されていると、導電率が最も小さくなる。最 大の導電率を有する状態に第1の電極と第2の電極とを 形成すれば、導電率の変化域が大きな3端子有機電子デ バイスを提供できる。

【0075】対電極間の配列方向を調整して、第1の電 極と第2の電極とを配置すれば、対電極間の導電率を調 整できる。また、電極の大きさの調整や、対電極間の距 離の調整により、導電率の変化域を調整することもでき る。

【0076】前記導電ネットワークの導電率は、前記導 電性有機薄膜に印加される電界により変化することもで きる。この例によれば、導電性有機薄膜に印加される電 界は、第1の電極又は第2の電極と第3の電極との電極 間にに印加する電圧で制御できる。したがって、第1の 電極と第2の電極それぞれを互いに異なる固定電位に設 定しておけば、第3の電極に印加する電圧により対電極 間に流れる電流の制御を行うこともできる。

【0077】前記有極性の官能基は、電界印加により分 極率が大きくなる分極性の官能基であってもよい。

【0078】上記の構成の如く、有極性の官能基が電界 印加により分極率が大きくなる官能基(以下、分極性の 官能基)であると、電界の変化に対する感度が極めて高 くなり、それに伴い応答速度も極めて高速になる。

【0079】前記分極性の官能基は、とくにカルボニル 基、オキシカルボニル基、エステル基またはカーボネイ ト基であることが好ましい。このような官能基を用いる と、電界の変化に対して応答速度が極めて高速な3端子 有機電子デバイスを提供できる。

【0080】前記第1の電極と前記第2の電極とが、前 記導電ネットワークの方向に配列配置されていてもよ い。この例によれば、対電極間の間隔を固定して、様々 な方向に第1の電極と第2の電極を配列配置させた場合 において、対電極間の導電率を最大に設定することがで きる。したがって、対電極間の導電率の変化域が大きな 有機電子デバイスを提供できる。

【〇〇81】前記導電性有機薄膜は、前記有機分子が単 分子層状に配列し、かつ、前記単分子層内に導電ネット ワークが形成されている導電単分子層としてもよい。こ 20 の例によれば、導電性及び導電異方性に優れ、並びに、 重合度が高い導電ネットワークを有する導電単分子層を 含む導電性有機薄膜を提供できる。

【0082】前記導電性有機薄膜は、1層の前記導電単 分子層よりなる、基板上に固定された導電性単分子膜、 又は、前記導電単分子層の累積された基板上に固定され た導電性単分子累積膜であってもよい。この例によれ は、膜厚が薄くても極めて良好な導電性を有する導電性 単分子膜及び導電性単分子累積膜を提供できる。また、 導電性単分子累積膜の場合、各導電性単分子層に導電ネ ークの方向に配列配置されていると電極間の導電率が最 30 ットワークが形成されているので、単分子累積膜の導電 ネットワークの導電率は、積層された単分子膜の層数に 依存する。したがって、導電単分子層の積層数を変更す ることにより所望の導電率を有する導電性有機薄膜を提 供できる。例えば、同一の導電性単分子層が積層された 導電性累積膜であれば、それに含まれる導電ネットワー クの導電率はほぼ比例する。

> 【0083】導電性単分子累積膜において、すべての単 分子層に形成された導電ネットワークの方向が同一であ る限り、各単分子層ごとに有機分子の配向の傾斜角が異 なっていてもよい。また、すべての単分子層を同一有機 分子から構成するものでなくとも良い。また、各導電性 単分子層ごとに異なる種類の有機分子から構成された導 電性単分子累積膜であってもよい。

【0084】基材上に固定された、導電性単分子膜又は 導電性単分子膜であってもよい。このとき、基材に最近 接する導電性単分子層が基材と化学結合で結合されてい ると、耐剥離性に優れる。

【0085】前記基板は、ガラスや樹脂フィルムなどの 電気絶縁性の基板、又は任意の基板表面に絶縁膜が形成 50 された絶縁膜付き基板であっても良い。基板はガラスや ポリイミド樹脂などであれば表面に活性水素を有するので、そのままでも使用できる。活性水素が少ない基板の場合は、 $SiCl_1$ 、 $HSiCl_1$, $SiCl_1$ O-($SiCl_2$ -O) $_n$ - $SiCl_1$ (但し、nは0以上6以下の整数)、 $Si(OH)_1$ 、 $HSi(OH)_1$, $Si(OH)_2$ 0-($Si(OH)_2$ -O) $_n$ - $Si(OH)_2$ (但し、nは0以上6以下の整数)などで処理するか、シリカ膜を形成するか、コロナ放電、プラズマ照射などで基材表面を活性化することにより活性水素を付与できる。

【0086】基板が電気絶縁性材料の場合は、リーク電流が小さく、動作安定性に優れる有機電子デバイスを提供できる。

【0087】本発明の有機導電膜は、電導度が高く、透明性も高い。この性質を利用した用途としては、電線、モーター、発電機、コンデンサー(キャパシター)、透明電極(【TO代替)、半導体装置配線・CPU配線(電気抵抗により発熱しない)、電磁波シールド、CRTガラス表面フィルター(静電気発生防止)等様々な用途が考えられる。

【0088】(実施の形態1)本実施の形態1においては、淳電性単分子膜を例にし、図1及至図4を参照しながら、導電性単分子膜の製造方法及びその構造を説明する。図12は有機分子の傾斜方向を説明するための概念図であり、基材1に結合した有機分子は、有極性官能基の部分で分子が回転しやすく、配向しやすいことを示している。また、図1A-Bは基材上に形成された導電性単分子膜を分子レベルにまで拡大した概念図であり、図1Aはその断面図であり、図1Bはその平面図である。

(1)基材表面に対する有機分子の固定工程 まず、活性水素を含まない有極性の官能基(例えばオキシカルボニル基(-OCO-))7及び共役結合で結合 する重合性基5(例えば1-ピロリル基(C,H,N

-))を有する有機分子からなる単分子膜4を、表面に活性水素を有するか付与した基材1上に形成する(成膜工程、単分子層形成工程)。有極性の官能基7に活性水素を含むと、下記に説明する分子末端のクロロシリル基と分子内反応(自己縮合)してしまい不都合である。

【0089】分子末端がクロロシリル基またはアルコキシシリル基を有するシラン系界面活性剤等のような基材に化学吸着する官能基を末端に有する有機分子であると、基材表面の活性水素との間で脱塩化水素反応または脱アルコール反応による脱離反応を起こし、基材に結合固定され、耐剥離性、耐久性の高い単分子膜を形成できる。また、単分子層形成工程後に、有機溶媒に浸漬して、未吸着の有機分子を洗浄除去する工程(以下、「洗浄工程」ともいう。)を行えば、表面に汚れのない単分子膜4が形成できる。

(2)配向工程

次に、単分子膜を構成する有機分子を所定の方向に配向させる。配向させるには、下記の方法がある。

【0090】(i) ラビング処理

傾斜処理工程では、図2に示すように、ラビング装置を 用いて単分子膜表面にラビング処理を行い、単分子膜を 構成する有機分子をラビング方向に配向させることがで きる。図2において、41はラビング布を、42はラビ ングロールを表す。

【0091】(ji) 偏光処理

図3に示すように、偏光板13を用いて偏光を照射する ことにより、単分子膜4を構成する有機分子を偏光方向 に配向させることができる。偏光としては、直線偏光が 好ましい。これらの配向方法を適用すれば、精度よく配 向させることができる。

【0092】また、単分子層形成工程より前に、ラビング装置を用いて基材表面にラビング処理を施しておけば(前処理工程)、単分子膜形成工程で該ラビング処理した基材に配向した単分子膜を形成できる。このときの配向方向は、ラビング方向と同一方向である。

【0093】(jii) 液切り配向処理

上記洗浄工程において、未吸着の有機分子を除去した。 後、図4に示すように、有機溶媒44の液面に対して所 定の傾斜角度を保ちつつ基材を引き上げれば、単分子膜 を構成する有機分子を液切り方向に配向させる(以下、 「液切り配向」という。)ことができる。

【0094】(iv) 溶液中での重合工程における分子のゆらぎによる配向

上記の3つの配向方法以外に、触媒重合及び/または電解酸化重合工程における分子のゆらぎによる配向でも良い。本発明で用いる有機分子は、内部に有極性官能基を含んでいるので、溶液中であれば、室温 (25°C)程度でも分子が回転などのゆらぎが起こりやすい。このため、例えば電解酸化重合工程における分子のゆらぎによる配向を利用することができる。

【0095】上記の4つの配向方法を単独で適用してもよいし、複数の配向方法を適用してもよい。異なる配向方法を組み合わせて、精度よく配向した状態にある配向した単分子膜を形成する際には、ラビング方向や偏光方向や液切り方向が同一方向になるようにすることが好ましい。

(3) 導電ネットワーク形成工程

40 次に、単分子膜を構成する分子相互を共役結合させて導電ネットワークを形成する。

【0096】共役結合で結合する重合性基が重合してなる共役系を形成できるのであれば、どのような方法であってもよい。単分子膜を構成する分子相互を重合又は架橋させて共役系を形成することができる。重合法としては、触媒重合法、電解重合法、エネルギービーム照射重合法等が利用でき、前記重台法を適用して重合又は架橋させることができる。このうち、触媒重台法及びエネルギービーム照射重合法は、予備ネットワーク形成に使用すると、重合速度が速いので効率よくネットワークを形

成できる。

【0097】共役結合可能基がエチニル基(アセチレン 基を含む)の場合は、触媒重合及び/又は電子線重合を 採用してポリアセチレンに重合することができる。

【0098】共役結合可能基がジェチニル基(ジアセチ レン基を含む)の場合は、触媒重合及び/又は光重合を 採用してポリジアセチレン又はポリアセンに重合すると とができる。

【0099】共役結合可能基がピロール基又はチオフェ してポリビロール又はポリチオチェンに重合することが できる。とくに最終工程は電解酸化重合法を行い、導電 ネットワークを完結させるのが好ましい。電解酸化重合 の一例として、反応温度は室温(25℃)程度で良く、 無触媒、純水溶液中で電界をかけることにより行う。も ちろん反応温度を高くしたりあるいは低くしたり、触媒 を使用したり、水以外の溶液を使用することは任意にで きる。電解酸化重合法では電極間に電界をかけて重合す るので、導電ネットワークが完成したか否かは、電極間 の通電状態を観察することにより容易に判断できる。す なわち、導電ネットワークが完成した場合は、電極間の 膜中を電流が急激に流れる現象が観察できる。

【0100】また、重合又は架橋させる工程を複数回行 うことにより、導電ネットワークを形成してもよい。例 えば、膜材料分子として、共役結合で結合する重合性基 を複数有する有機分子を用いた場合、前記有機分子から なる単分子層に含まれる複数の平面に導電ネットワーク を形成することができる。更に、重合又は架橋を複数回 行う際、各回でとに重合法が異なっていてもよい。

【0101】また、単分子膜を構成する有機分子がエネ ルギービーム照射重合性基を有する場合、偏光を照射す れば、単分子膜を配向させると同時に、導電ネットワー クを形成することも可能である。

【0102】本実施形態において、有極性官能基7を分 子の中間部分に存在させると、その部分で分子は自由回 転しやすので、配向処理の際に導電性基5が一定の方向 に配向しやすく、かつ、最終工程における電解酸化重合 の際に他の分子の導電性基5が近接して重合し、高分子 化しやすくなる。

【0103】図1A-Bは、前記のようにして得られた 40 分子膜4であり、基材1上に共有結合され、導電性基5 が共役結合によりポリマー化して導電ネットワークを形 成している状態を示している。

【0104】(実施の形態2)単分子膜を形成する材料 分子として、前記活性水素を含まない有極性官能基、例 えばエステル基 (-СОО-)、カルボニル基 (-СО 一)及びカーボネイト(-OCOO-)基から選ばれる 少なくとも一つの基である有極性の官能基を有する有機 分子を用いてもよい。これ以外は上記実施の形態1と同 様にして、有極性の官能基を有する有機分子の集合群か 50 【0112】第3の製造方法を適用する場合は、すべて

らなる単分子膜であって、その単分子膜には、前記有機 分子の集合群を構成する分子相互が共役結合で所定の方 向に連なる導電ネットワークを各単分子層内に有する電 界応答型導電性単分子膜が製造できる。

【0105】(実施の形態3)本実施の形態3は、電界 応答型導電性有機薄膜が単分子累積膜である場合につい て、その製造方法及び構造を説明する。必要に応じて図 5 A - Dを参照する。

【0106】まず、導電性単分子累積膜の製造方法につ ン基の場合は、触媒重合及び/又は電解酸化重合を採用 10 いて説明する。主に、下記の3種の方法で導電性単分子 累積膜の形成が可能である。

> (1)第1の製造方法は、単分子層を形成する工程を繰 り返して単分子層を積層させた後、各単分子層を所定の 方向に一括配向させ、続いて各単分子層内に導電ネット ワークを形成する方法である。

(2)第2の製造方法は、単分子層を形成する工程と、 続いて単分子層を配向させることを繰り返して配向した 単分子累積層を形成した後、その配向した単分子累積膜 の各単分子層に導電ネットワークを一括形成する方法で 20 ある。

(3)第3の製造方法は、単分子層を形成し、続いてそ の単分子層を配向させ、更に続いてその単分子層に導電 ネットワークを形成することを繰り返し行う方法であ る。

【0107】単分子層の配向方法及び単分子層内の導電 ネットワーク形成方法としては、上記実施の形態1の方 法が同様に利用できる。ただし、配向処理法は重合前に ついてのみ有効な配向法である。

【0108】上記3種の製造方法は、どの様な方法で単 分子層を配向させるか、どの様な方法で導電ネットワー クを形成させるか等により最適化されることが好まし い。更に、導電性単分子層を何層積層させた導電性単分 子累積膜を形成するか等により、いずれの製造方法を適 用するかを選択することが好ましい。

【0109】積層数の多い導電性単分子累積膜を形成す るのであれば、第2の製造方法若しくは第3の製造方法 を適用することが好ましい。第1の方法であれば各単分 子層ととの導電性の均一性を保つことが難しくなる。

【0110】第1の製造方法を適用する場合、配向方法 としては光配向法又はラビング配向法を適用し、かつ、 重合法としてはエネルギービーム照射重合法又は電界重 合法が好ましい。更に、積層数の増加と共に、配向方法 として光配向法の適用が有効となる。重合法として触媒 重合法を適用すると、基材側下層の単分子層に導電ネッ トワークを形成することが困難となる。

【0111】第2の製造方法を適用する場合も、第1の 製造方法と同様であるが、配向を行う工程が増すため、 配向処理工程(傾斜処理工程)では光配向法を適用する ことが簡便である好ましい。

の配向方法及びすべての重合方法が可能である。工程が 多いため、製造効率は低くかつ製造コストは高くなる が、導電性に優れる単分子層からなり、かつ、各単分子 層でとの導電性の均一性に優れる導電性単分子累積膜が 形成できる。

【0113】上記一連の工程により、電界応答性の官能基を有する有機分子の集合群からなる単分子累積膜であって、その単分子累積膜には、前記有機分子の集合群を構成する分子相互が共役結合で所定の方向に連なる導電ネットワークを有する電界応答型導電性単分子累積膜が 10 製造できる。

【0114】次に、上記のようにして形成された導電性 単分子累積膜の構造例を図5A-Dに示す。図5A-D は単分子累積膜の構造例を示す分子レベルまで拡大した 概念図である。図5Aは化学吸着法を用いた累積膜を示 し、各単分子層の配向方向が同一方向であるX型導電性 単分子累積膜の断面図である。図5Bは1層目が化学吸 着膜、2層目以降がラングミュアーーブロジェット法を 用いて形成された累積膜であり、各単分子層の配向方向 が同一方向であるY型導電性単分子累積膜の断面図であ る。図50はすべて化学吸着法によって形成された累積 膜であり、各単分子層でとに配向方向が異なるX型導電・ 性単分子累積膜の断面図である。図5 Dはすべて化学吸 着法によって形成された累積膜であり、各単分子層ごと に2つの配向方向のいずれかに配向したX型導電性単分 子累積膜の断面図である。図5A-Dにおいて、1は基 材、4は単分子層、5は共役結合による導電性基、7は 電界応答性官能基である。図5A-Dの各種の導電性単 分子累積膜の各単分子層4の平面図は図1 Bと同様であ

【0115】(実施の形態4)3端子有機電子デバイスの製造方法及び構造を図6A-Bに基づいて説明する。図6A-Bは、3端子有機電子デバイスの構造の例を模式的に説明した説明図である。

【0116】まず、絶縁性の基板上、又は任意の基板1 1表面に絶縁膜18が形成された絶縁膜付き基板上に第 3の電極17を形成する。次に、直接又は絶縁膜19を 介して前記第3の電極13を覆うように、有極性の官能 基及び共役結合で結合する重合性基を有する有機分子の 集合群から成る有機薄膜を形成する。次に、その有機薄 傾を構成する有機分子を傾斜させ、次に、有機薄膜を構 成する分子相互を共役結合させ導電ネットワーク15を 形成する。次に、前記導電ネットワーク15に接触する ように、互いに離隔し且つ第3の電極17とも離隔した 第1の電極12と第2の電極13とを形成すれば3端子 有機電子デバイスが製造できる。

【0117】 これにより、基板上に形成された、第1の 電極12と、前記第1の電極12と離隔した第2の電極 13と、前記第1の電極12と第2の電極13を電気的 に接続する導電性有機薄膜14と、基板11と有機薄膜 50

14の間に挟まれ、それぞれと絶縁された第3の電極17と、を備えた3端子有機電子デバイスであって、前記第3の電極17は、前記第1の電極又は前記第2の電極と前記第3の電極間の電圧印加により有機薄膜14に作用させる電界を制御できる電極であり、有機薄膜14は、有極性の官能基を有する有機分子の集合群からなり、有機分子の集合群を構成する分子相互が共役結合した導電ネットワーク5を有する3端子有機電子デバイスが提供できる。

【0118】図6Aは第1の電極12と第2の電極13が、基板11上の絶縁膜18の表面と導電性単分子膜14の側面に接した構造の3端子有機電子デバイスであり、図6Bは第1の電極12と第2の電極13が導電性単分子膜14表面に形成された構造の3端子有機電子デバイスである。第1の電極12及び第2の電極13の形成において、電極を形成する物質を蒸着した後、フォトレジストでマスクバターンを形成し、エッチングにより所定の第1の電極2と第2の電極3を形成する場合、異なるマスクバターンを用いることにより図6A又は図6Bの構造の3端子有機電子デバイスを製造できる。図6A-Bにおいて、8は有極性の官能基、15は電解重合により共役結合した基である。

【0119】図6Aに示された構造であれば、任意の位置に重合性基を含む有機分子が利用でき、また分子に重合性基が複数存在する場合も第1と第2の電極間を電気的に接続する複数層の導電ネットワークを形成できる。さらに単分子累積膜であれば、各単分子層に導電ネットワークを形成できる。

【0120】図6日に示された構造であれば、導電ネットワークが基板と反対側の導電性単分子膜14表面に存在していないと、導電ネットワーク5と電極12,13との間の電気伝導が悪くなる。したがって、材料物質としては分子の端末に重合性基を有する有機分子を用いた方がよい。

【0121】このような有機分子を用いた場合、導電性単分子膜14の導電ネットワークと電極との接触面積を大きくとれる為、接点抵抗を低減することが可能となり、単分子膜であっても良好な導電性を確保できる利点がある。

【0122】さらに高い導電性が必要であれば、第1の電極12と第2の電極13の電極間に導電ネットワークを有する被膜を形成することができる。例えば、前記前記対電極工程後に、電解重合性の官能基を含む物質を溶かした有機溶媒中に浸漬し、第1の電極12と第2の電極13の電極間に第1の電圧を印加し且つ第1の電極12又は第2の電極13と有機溶媒に接触し有機薄膜の上方に配置された外部電極との電極間に第2の電圧を印加すれば、第1の構造の導電ネットワークを有する単分子膜又は単分子累積膜の表面にさらに被膜が形成され且つ前記被膜を構成する分子相互は電解重合して第2の構造

の導電ネットワークが形成される。

【0123】また、被膜を形成する際、電解重合性の官 能基を含む物質を塗布し、第1と第2の電極間に電圧を 印加すれば、同様に導電ネットワークを有するポリマー 膜状の波膜を形成できる。

【0124】有機薄膜を構成する有機分子が単分子層状 に配列した単分子膜を含まない有機薄膜であれば、図6 Aまたは図6Bのどちらの構造であっても上記のような 差けない

【0125】次に、この3端子有機電子デバイスの電界 印加による導電率の時間変化及びスイッチング動作を図 7A-Bに基づいて説明する。図7Aは、第3の電極1 7に電圧を印加した場合の導電率の変化を定性的に示し た模式図である。第3の電極13に印加した電圧は有機 薄膜に作用された電界に比例すると考えると、横軸とし て印加電界又は第3の電極17の印加電圧をとることは 等価であるので以下、印加電圧を用いて説明する。また 導電ネットワークの導電率の変化は、第1の電極12と 第2の電極13との間に一定電圧を印加した状態での電 流の変化で説明する。

【0126】導電ネットワークの導電率は第3の電極1 7に印加された電圧により変化し、印加電圧の増加とと もにある一定の値に収束していくことがわかる。つまり 第3の電極に電圧が印加されていないときの導電率と収 束した導電率との範囲内で、第3の電極の印加電圧で導 電率を制御できる。

【0127】図7Aにおいて、電圧印加中の電流が0A の場合を示しているが、電圧印加中のオン電流又は電圧 印加されていないオフ電流のいずれか一方がOVの場合 に限定されない。また、電圧印加により電流値が減少す る場合を例示したが、電流が増加するものであっても良 い。これらは有機薄膜の構成や導電ネットワークの構造 等に依存する。

【0128】電圧を印加していない第1の導電率を有す る安定状態と所定の電圧を印加した第2の導電率を有す る安定状態との状態間の移行により、導電ネットワーク の導電率のスイッチングが可能となる。

【0129】図7Bは3端子有機電子デバイスのスイッ チング動作の概念図であり、第1の電極12と第2の電 極13との電極間に電圧を印加した状態での、所定の電 40 圧印加状態(Von)のオン電流(Ivon)と電圧を印加 していない状態(Voff)のオフ電流(Iv-off)がスイ ッチング動作することを示している。したがって、図7 Bから、第3の電極17に印加される所定の電圧のオン ・オフで、電流をスイッチングできることがわかる。

【0130】電圧のオン・オフによるスイッチングの場 合を示したが、第3の電極17に第1の電圧を印加した 場合の電流値と第2の電圧を印加した場合の電流値との 間のスイッチングも可能である。

抵抗としても利用できる。

[0132]

【実施例】以下、実施例に基づいて、本発明の内容を具 体的に説明する。本発明は下記の実施例により限定され ない。下記の実施例において、単に%と記載しているの は重量%を意味する。

26

【0133】(実施例1)まず、導電ネットワークが形 成可能な1-ピロリル基(C,H,N-)と、分極性の官 能基であるオキシカルボニル基(-ОСО-)と、基板 表面の活性水素(例えば水酸基(-〇H))と脱塩化水 素反応するトリクロロシリル基 (-SiCl;)とを有 する下記化学式(13)の物質(PEN:6-pyrrolylhe xyl-12,12,12-trichloro-12-siladodecanoate) を下記 工程1~5にしたがって合成した。

[0134]

[(1:13]

20 【0135】I. 前記化学式(1)の物質(PEN)の 合成方法

工程1 6-プロモ-1-(テトラヒドロピラニルオキシ)へ キサンの合成

500m1の反応容器に6-ブロモ-1-ヘキサノール197.8g(1.0 9mo1)を仕込み、5℃以下に冷却した。これにジヒドロビ ラン102.1q(1.21mol)を10°C以下の温度で滴下した。滴 下終了後、室温に戻して1時間攪拌させた。反応により 得られた残渣をヘキサン/IPE(ジイソプロピルエーテ ル) = 5/1 にてシリカゲルカラム精製して263.4gの6-30 ブロモ-1-(テトラヒドロピラニルオキシ)ヘキサンを得 た。収率は90.9%であった。工程1の反応式を下記式 (14) に示す。

[0136]

【化14】...

【0137】工程2 N-[6-(テトラヒドロピラニ ルオキシ) ヘキシル] ピロールの合成

アルゴン気流下、2リットルの反応容器にピロール38.0 q(0.567mol)、脱水テトラヒドロフラン(THF) 200m1 を仕込み、5℃以下に冷却した。これに1.6Mのn-ブチ ルリチウムヘキサン溶液354m1(0.567mo1)を10℃以下 で滴下した。同温度で1時間攪拌させた後、ジメチルス ルホキシド600m1を加えてTHFを加熱留去して溶媒置 換した。次に、6-ブロモ-1-(テトラヒドロピラニルオキ シ)ヘキサン165.2q(0.623mo1)を室温にて滴下した。滴 下後、2時間、同温度で攪拌させた。

【0138】反応混合物に水600molを加え、ヘキサン抽 【0131】本発明の導電性有機薄膜は電界制御の可変 50 出し、有機層を水洗した。無水硫酸マグネシウムにて乾

爆後、溶媒留去した。残渣をヘキサン/酢酸エチル= 4 /1 にてシリカゲルカラム精製して107.0 ϕ 0N - [6-(テトラヒドロピラニルオキシ)ヘキシル] ピロールを得た。収率75.2%であった。工程200反応式を下記 *

27

*式(15)に示す。 【0139】 【化15】

【0140】<u>工程3 N-(6-ヒドロキシへキシル)-ピ</u>ロールの合成

1リットルの反応容器に上記で得られたN-[6-(FF-FE)] にロビラニルオキシ)へキシル] ピロール105.0g (0.418mol)、メタノール450ml、水225ml、濃塩酸37.5mlを仕込み、室温にて6時間撹拌させた。反応混合物を飽和食塩水750mlに注加し、IPE抽出した。有機層を飽和食塩水洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥させ、溶煤留去した。得られた残渣をn- ペキサン/酢酸エチル=3 / 1にてシリカゲルカラム精製し、63.1qのN-(6-ヒドロキシヘキシル)-ピロールを得た。収率90.3%であった。工程3の反応式を下記式(16)に示す。

[0141] [化16]

工程3

$$N + CH_2 + OTHP - N + CH_2 + OH$$

【0142】<u>工程4 N-[6-(10-ウンデセノイル</u> オキシ) ヘキシル] - ヒロールの合成

2リットルの反応容器にN-(6-ヒドロキシへキシル)-ピロール62.0q(0.371mol)と、dryピリジン33.2 g(0.420mol)、dryトルエン1850ml を仕込み、20°C以下で10-ウンデセノイルクロリド75.7q(0.373mol)のdryトルエン300ml溶液を滴下した。滴下時間は30分であった。その後、同温※

【0146】なお、末端のトリクロロシリル基をトリメトキシシリル基に置換するには、前記化学式1のPENを3モル倍のメチルアルコールと室温(25℃)で撹拌し、脱塩化水素反応させる。必要に応じて前記塩化水素は水酸化ナトリウムを加えて塩化ナトリウムとして分離する。

【0147】得られたPENについて、図15にNMR のチャート、図16にIRのチャートをそれぞれ示す。 (NMR)

- (1)測定機器:装置名AL300(日本電子株式会社 製)
- (2)測定条件: ¹H-NMR(300MHz)、サンプル30mgをCDC1,に溶解し測定。

(赤外線吸収スペクトル: IR)

※度にて1時間攪拌させた。反応混合物を氷水1.5リットルに注加し、1N塩酸で酸性にした。酢酸エチル抽出0 し、有機層を水洗、飽和食塩水洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥させ、溶媒を除去し、128.2gの粗体を得た。これをn-ヘキサン/アセトン=20/1にてシリカゲルカラム精製し、99.6gのN-[6-(10-ウンデセノイルオキシ)ヘキシル]-ピロールを得た。収率80.1%であった。工程4の反応式を下記式(17)に示す。

[0143] [(£17]

工器4

20
$$N - (CH_2)_8 OH - (CH_2)_8 O - (CH_2)_8 CH = CH_2$$

【0144】工程5 PENの合成

100mlキャップ付き耐圧試験管にN-[6-(10-ウンデセノイルオキシ)へキシル]-ピロール2.0g(6.0×10-mol)、トリクロロシラン0.98g(7.23×10-mol)、HPtC1。6H,0の5%イソプロピルアルコール溶液0.01gを仕込み、100℃で12時間反応させた。この反応液を活性炭で処理した後、2.66×10'Pa(20Torr)の減圧下で低沸点成分を留去0た。2.3gのPENを得た。収率81.7%であった。工程5の反応式を下記式(18)に示す。

[0145] [化18]

製作所製)

(1) 測定機器:装置名270-30型(株式会社日立

(2) 測定条件: neat (サンプルを2枚のNaCT板に挟み 測定)

II. 分子膜の形成方法

前記化学式(1)のPENを用い、脱水したジメチルシリコーン溶媒で1wt%に薄めて化学吸着液を調製した。 【0148】次に、絶縁性のポリイミド基板31(または導電性のメタル基板表面に第1の絶縁膜、例えばシリカ膜38を形成しても良いし、ガラス板を用いても良い。)の表面にアルミニウム(A1)を蒸着し、フォトリソグラフィ法を適用し長さが15μmで幅が40μmの第3の電極23をエッチング形成した。さらに前記A501製の第3の電極37を電解酸化して表面に絶縁性のア

ルミナ(A1,O,) 膜39を形成した(図8)。

【0149】次に、単分子膜を形成する部分を残してレ ジストで覆われたボリイミド基板31を室温(25℃) の化学吸着液に1時間浸漬して、基板表面で脱塩化反応 させ、レジスト開口部に選択的に薄膜を形成した。次 に、基板上に残った未反応の前記物質を無水クロロフォ ルムで洗浄除去し、続いて前記フォトレジストのマスク パターンを除去して、前記物質よりなる単分子膜34a を選択的に成膜した(図9)。

29

【0150】このとき、開口部のボリイミド基板31表 10 面(シリカ膜38とA1,〇,膜39表面)には活性水素 を含む水酸基が多数存在するので、前記物質のクロロシ リル基(-SiCl)が水酸基と塩化水素反応を生じて ポリイミド基板31表面に共有結合した下記化学式(1 9)で示される分子で構成された単分子膜34が形成さ れた。

[0151] 【化19】

【0152】III. 分子膜の配向方法

次に、単分子膜34 aが形成されたポリイミド基板31 をクロロフォルム溶液中に浸漬して洗浄し、クロロフォ ルム溶液から引き上げる際、第1の電極から第2の電極 に向かう方向と平行に液切りできるようにポリイミド基 板31を垂直に立てた状態で引き上げ、第1の電極から*

【0155】VI.測定

この3端子有機電子デバイスでは、第1の電極22と第 2の電極23との間は、ボリビロール型の導電ネットワ ーク35で接続されている。得られた有機導電膜34C を、市販の原子間力顕微鏡(AFM)(セイコーインス ツルメント社製、SAP 3800N)を用い、AFM - CITSモードで、電圧: 1 m V、電流: 160 n A の条件における電導度 p は、室温 (25℃) においてド -7 $\cot c \rho > 1 \times 10' S/c m c book. Chit.$ 前記電流計 $1 \times 10^7 \text{S/cm}$ までしか測定することが できず、針がオーバーして振り切れてしまったからであ る。電導度の良好な金属である金は室温(25℃)にお いて5. 2×10'S/cm、銀は5. 4×10'S/c mであることからすると、本実施例の有機導電膜の電導 度ρは驚くべき高い導電性である。前記値からすると、 本発明の有機導電膜は、「超金属導電膜」ということが できる。

【0156】本発明において、有機導電膜の電導度ρを 下げることは、導電ネットワークを不完全なものとした *第2の電極に向かって一次配向した単分子膜34 bを形 成した(図10)。

IV. 電極の形成方法

次に、全面にニッケル薄膜を蒸着形成した後、ホトリソ グラフィ法を適用して、ギャップ間距離が10μm、長 さが30μmの第1の電極22と第2電極23とを第3 の電極37を挟むようにエッチングして形成した。

V. 電解重合法

その後、純水溶液中で、電極間に5V/cmの電解を印 加し電解酸化重合させた。電解酸化重合の条件は、反応 温度25℃、反応時間5時間であった。これにより、電 解重合して導電ネットワーク35を第1の電極22及び 第2の電極23の電極間を電気的に接続した。このと き、電界の方向に沿って共役結合が自己組織的に形成さ れて行くので、完全に重合が終われば、第1の電極22 と第2の電極23とは導電ネットワーク35で電気的に 接続されていることになる。最後に、第3の電極37を 基板31側から取り出して、3端子有機電子デバイスを 製造できた(図11)。得られた有機導電膜34Cの膜 20 厚は約2.0 nm、ポリピロール部分の厚さは約0.2 nm、有機導電膜34Cの長さは10mm、幅100μ mであった。

【0153】下記化学式(20)に得られた有機導電膜 ポリマーの1ユニットを示す。

[0154] 【化20】

【0157】次に前記で得られた有機導電膜に対し、第 1の電極22と第2の電極23との間に17の電圧を印 加し、かつ、第1の電極22と第3の電極27との間の 電圧をOVにすると、1mA程度の電流が流れた。

【0158】次に、第1の電極22と第2の電極23と の間に1Vの電圧を印加した状態で、第1の電極22と 第3の電極37との間に5Vの電圧を印加すると、第1 の電極22と第2の電極23との電極間の電流値がほぼ 40 0 A (ゼロアンペア)となった。その後、第1の電極2 2と第3の電極27との間の電圧を5Vから0Vにもど すと元の導電率が再現された。

【0159】このような導電性の低下は、第3の電極3 7と第1の電極22との電極間に5Vの電圧を印加した 際、有極性の官能基であるオキシカルボニル基(-OC 〇一)の分極が大きくなることにより、ポリピロール型 の共役系が歪み導電ネットワーク35の導電率が低下す ることにより生じたと考えられる。

【0160】すなわち、第1の電極22と第3の電極3 り、分子の配向度を低下させることにより、容易にでき 50 7との間に印加された電圧で、前記導電ネットワークの

導電率を制御して第1の電極22と第2の電極23との 間に流れる電流をスイッチングできた。

【0161】(実施例2)以下に示す合成工程によっ て、下記化学式(21)に示す[6-[(3-thienvl)hexyl-1 2.12.12-trichloro-12-siladodecanoate]] (TEN)を 合成した。

[0162]

[{£21}

$$CH_{2} \rightarrow 0 - CH_{2} \rightarrow SIC1,$$

【0163】(1)工程1 6-ブロモ-1-(テトラ ヒドロピラニルオキシ) ヘキサンの合成

下記化学式(22)に示す反応を行い6-プロモー1-(テトラヒドロピラニルオキシ) ヘキサンを合成した。 まず、500mLの反応容器に6-ブロモー1-ヘキサ ノール197.8g(1.09mol)を仕込み、5°C 以下に冷却した後、これに、ジヒドロピラン102.1 g(1,21mol)を10℃以下で滴下した。滴下終 20 了後、室温に戻して1時間攪拌した。

[0164]

【化22】

工程1

$$Br - \left(CH_2\right)_s OH - Br - \left(CH_2\right)_s OTHP$$

【0165】得られた残渣をシリカゲルカラムに供し、 溶出溶媒としてヘキサン/ジイソプロピルエーテル(I PE) 混合溶媒(体積比5:1)を用いて精製し、26 3. 4gの6-プロモー1 (テトラヒドロピラニルオキ シ) ヘキサンを得た。この際の収率は90.9%であっ

(2) 工程2 3-[6-(テトラヒドロビラニルオキシ)へ キシル]チオフェンの合成

下記化学式(23)に示す反応を行い3-[6-(テトラヒド ロピラニルオキシ)ヘキシル]チオフェンを合成した。

[0166]

【化23】

工程2

$$\begin{array}{c}
B_r - CH_2 \\
\hline
S
\end{array}$$
OTHP

【0167】まず、アルゴン気流下、2Lの反応容器に 削ったマグネシウム25.6g(1.06m。1)を仕 込み、さらに、6-ブロモー1-(テトラヒドロビラニ ル) ヘキサン140.2g(0.529mol)を含む ドライテトラヒドロフラン(ドライTHF)溶液4Lを 室温で滴下した。この際の滴下時間は1時間50分であ 50

って、発熱反応を起した。その後、室温で1.5時間攪

拌して、グリニャール試薬を調製した。

【0168】つぎに、アルゴン気流下、新たな2し反応 容器に3-プロモチオフェン88.2g(541mo 1) とジクロロビス(トリフェニルフォスフィン)ニッ ケル(II)3.27gとを仕込み、前記調製したグリニ ャール試薬全量を室温で滴下した。この際、前記反応容

器内の温度を室温(50℃以下)に保ち、滴下時間は、 30分とした。滴下後、室温で23時間攪拌した。

10 【0169】この反応混合物を、0℃に保った0.5 N HCl 1.3Lに添加し、IPE抽出を行った。得 られた有機層を水洗し、さらに飽和食塩水で洗浄した 後、無水硫酸マグネシウムを添加して乾燥させた。そし て、溶媒を留去し、3-[6-(テトラヒドロピラニルオキ シ)ヘキシル]-チオフェンを含む粗体199.5gを得 た。この粗体は、精製せずに次の工程3に供した。

(3) 工程3 3-(6-ヒドロキシヘキシル) -チオ フェンの合成

下記化学式(24)に示す反応を行い3-(6-ヒドロ キシヘキシル) - チオフェンを合成した。

[0170]

[化24]

工程3

$$\left(\begin{array}{c} \text{CH}_{2} \right)_{s} \text{ OTHP} \end{array}$$

【0171】1しの反応容器に、前記工程2で得られた 未精製3-[6-(テトラヒドロビラニルオキシ)ヘキシル]-チオフェン199.5g、メタノール450mL、水2 30 25 m L および 濃塩酸 37.5 m L を仕込み、 室温で 6 時間攪拌して反応させた。この反応混合物を飽和食塩水 750mLに添加し、IPE抽出を行った。そして、得 られた有機層を飽和食塩水で洗浄し、さらに無水硫酸マ グネシウムで乾燥させた後、溶媒留去して3-(6-ヒ ドロキシヘキシル) - チオフェンを含む粗体 148.8 gを得た。この粗体をシリカゲルカラムに供し、溶出溶 媒としてn-ヘキサン/酢酸エチル混合溶媒(体積比 3:1)を用いて精製し、84.8gの3-(6-ヒド ロキシヘキシル)-チオフェンを得た。この際の収率 40 は、工程2で得られた3-[6-(テトラヒドロピラニルオキ シ)ヘキシル] - チオフェンを含む粗体に対して87.0 %であった。

(4) 3-[6-(10-ウンデセノイルオキシ)ヘキシル]-チ オフェンの合成

下記化学式 (25) に示す反応を行い3-(6-(10 - ウンデセノイルオキシ) ヘキシル) - チオフェンを合 成した。

[0172]

[125]

T理A $\frac{1}{\left(CH_{2} \right)^{\frac{1}{2}}} O - \frac{1}{C} - \left(CH_{2} \right)^{\frac{1}{2}} CH = CH_{2}$

【0173】2Lの反応容器に、工程3で得られた3-(6-ヒドロキシヘキシル) - チオフェンを含む粗体8 4. 4g(0.458mol)、ドライピリジン34、 9g(0.442mol) およびドライトルエン145 0mLを仕込み、20℃以下の状態で、さらに10-ウ ンデセノイルクロリド79.1g(0,390mol) 10 フェンを得た。この際の収率は、前記工程3で得られた を含有するドライトルエン溶液250mLを滴下した。 滴下時間は、30分とし、その後、同じ温度で23時間 攪拌して反応させた。得られた反応混合物を氷水2 L に 添加し、さらに1N塩酸75mLを加えた。この混合液 を酢酸エチル抽出して、得られた有機層を水洗し、さら に飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムを添 加して乾燥させる、溶媒を除去することにより、3-[6-*

* (10-ウンデセノイルオキシ)ヘキシル1-チオフェンを含 有する粗体161.3gを得た。この粗体をシリカゲル カラムに供し、溶出溶媒としてn-ヘキサン/アセトン 混合溶媒(体積比20:1)を用いて精製し、157. 6gの3-[6-(10-ウンデセノイルオキシ)ヘキシル1-チオ 3-(6-ヒドロキシヘキシル)-チオフェンを含む粗 体に対して98.2%であった。

(5) 工程5 TENの合成

下記化学式(26)に示す反応を行いTENを合成し

[0174] [化26]

【0175】(a)まず、100mLのキャップ付き耐 圧試験管に、3-[6-(10-ウンデセノイルオキシ)へ キシル]-チオフェン10.0g(2.86×1012m ol)、トリクロロシラン4.65g(3.43×10 4mol) およびH, PtCl。・6H, 0を5重量%の 割合で含有するイソプロピルアルコール溶液0.05g を仕込み、100℃で14時間反応させた。との反応液 30 を活性炭で処理した後、減圧下で低沸点成分を留去し た。減圧条件は、2.66×10' Pa(20Torr)とした。

【0176】(b)同様に、100mLキャップ付き耐 圧試験管に、3-[6-(10-ウンデセノイルオキシ)ヘキシ ル]-チオフェン39.0g(1.11×10 $^{-1}$ mo l)、トリクロロシラン18.2g(1.34×10⁻¹ mol)、H₂PtCl₈・6H₂0を5重量%の割合で 含有するイソプロビルアルコール溶液 0.20gを仕込 み、100℃で12時間反応させた。この反応液を活性 炭で処理した後、減圧下で低沸点成分を留去した。減圧 40 電膜は可視光線のもとでは透明であった。 条件は前述のとおりである。

【0177】(a)と(b)で得られた残渣を混合し、 これにアルゴンガスを1時間通して塩酸ガスを除去する ことによって、65.9gの目的物TENを得た。この 際のTENの収率は、前記工程 4 で得られた 3-[6-(10-ウンデセノイルオキシ)ヘキシル]-チオフェンを含む粗 体に対して97.2%であった。

【0178】得られたTENについて、IR分析および NMR分析を行った。以下にその条件および結果を示 す。なお、図17にNMRのチャート、図18にIRの 50 ント社製、SAP 3800N)を用い、AFM-CI

チャートをそれぞれ示す。

(NMR)

(1)測定機器:装置名AL300(日本電子株式会社

(2) 測定条件: ¹H-NMR(300MHz)、サン プル30mgをCDCl,に溶解し測定。

(赤外線吸収スペクトル: IR)

(1)測定機器:装置名270-30型(株式会社日立 製作所製)

(2) 測定条件: neat (サンプルを2枚のNaCT板に挟み 測定)

得られたTENを用いて実施例1と同様にポリチェニレ ンからなる導電性分子膜を電解重合法により形成した。 得られた有機導電膜の膜厚は約2.0 nm、ポリチェニ レン部分の厚さは約0.2 nm、有機導電膜の長さは1 Omm、幅100μmであった。また、得られた有機導

【0179】下記化学式(27)に得られた有機導電膜 ポリマーの1ユニットを示す。

[0180]

【化27】

【0181】この有機導電膜を、実施例1と同様に、市 販の原子間力顕微鏡(AFM)(セイコーインスツルメ

TSモードで、電圧: 1mV、電流: 160 n A の条件 で電導度を測定した。その結果、電導度ρは、室温(2 5℃) においてドープなしでρ>1×10′S/cmで あった。

【0182】(実施例3)本実施例においては、液切り 配向処理後に第1の電極22から第2の電極23に向か う方向を偏光方向とする偏光した可視光を500mJ/ cm'程度照射すると、配向性の高い単分子膜24bが 得られた。また、このとき、偏光方向を第1の電極22 から第2の電極23に向かう方向と45°で交叉する方 向に設定して同様の照射を行うと、単分子膜を構成する 有機分子は、当初の引き上げ方向から動き、偏光方向と 略平行方向に配向した。

【0183】このように、液切り配向処理及び偏光照射 による配向処理を施した後、導電ネットワーク形成工程 を行うと極めて導電性に優れた導電性単分子膜24cを 形成できた。

【0184】 ここで、有極性の官能基が分極性のオキシ カルボニル基であると、スイッチングを極めて高速で行 えた。オキシカルボニル基以外に、カルボニル基、エス テル基等の官能基を有する分子を使用できた。

【0185】また、導電ネットワーク35としてポリア セチレン型、ポリジアセチレン型、ポリアセン型、ポリ ピロール型、ポリチェニレン型の共役系が使用でき、導 電率が高かった。また、導電ネットワークを形成する共 役結合で結合する重合性基として、電解重合性の官能基 としてのピロール基以外に、同じくチェニレン基が利用 できた。なお、重合方法を変えれば、アセチレン基、ジ アセチレン基を有する物質も利用できた。

【0186】単分子膜又は単分子累積膜の作製には、化 30 学吸着法以外に、ラングミュアーブロジェット法を使用

【0187】また、有機薄膜を重合する工程の前に、第 1の電極22と第2の電極23を形成する工程を行う と、導電ネットワークの形成に際して、第1の電極22 と第2の電極23を電解重合に利用できた。すなわち、 電解重合性の官能基としてピロール基又はチェニレン基 を有する有機分子の集合群からなる有機薄膜の第1の電 極22と第2の電極23との電極間に電圧を印加し第1 の電極22と第2の電極23との電極間の有機薄膜を選 40 択的に電解重合できた。

【0188】基板上に第3の電極37とピロール基又は チェニレン基を有する有機分子の集合群からなり配向し た単分子膜34bと、第1の電極と、第2の電極と、を 形成した後に、ピロール基又はチェニレン基を含む物質 を溶かした有機溶媒中に浸漬して、第1の電極22と第 2の電極23との間に第1の電圧を印加し、且つ第1の 電極22又は第2の電極23と前記有機溶媒に接触し、 配向した単分子膜34bの上方に配置された外部電極と の電極間に第2の電圧を印加して、配向した単分子膜3 50 ガラス転移(Tg)点の低い基板を用いても十分に高画

4 b の表面に被膜を形成すると同時に単分子膜と被膜の それぞれにポリピロール型又はポリチェニレン型の導電 ネットワークを形成できた。この場合、有機電子デバイ スは、それぞれに導電ネットワークを有する単分子膜層 とポリマー膜状の被膜層とからなるチャネル部を有す

【0189】また、基板上に第3の電極37とピロール 基又はチェニレン基を有する有機分子の集合群からなる 配向した単分子膜34bと第1の電極22と第2の電極 23とを形成し、配向した単分子膜34bにポリヒロー ル又はポリチェニレン型の第1の構造の導電ネットワー クを形成した後に、ピロール基又はチェニレン基を含む 物質を溶かした有機溶媒中に浸漬して、第1の電極22 と第2の電極23との間に第1の電圧を印加し、且つ前 記第1の電極22又は第2の電極23と前記有機溶媒に 接触し導電性単分子膜34cの上方に配置された外部電 極との間に第2の電圧を印加して、導電ネットワークが 形成された単分子膜34cの表面にさらに被膜を形成す ると同時に被膜にポリピロール型又はポリチェニレン型 の第2の構造の導電ネットワークを形成できた。この場 合、有機電子デバイスは、それぞれに導電ネットワーク を有する単分子膜層とポリマー膜状の被膜層とからなる チャネル部を有する。

【0190】導電ネットワークの形成において、電解重 合以外では、重合性基として触媒重合性の官能基である ピロール基、チェニレン基、アセチレン基、ジアセチレ ン基等を有する有機分子の集合群からなる単分子膜又は 単分子累積膜の分子相互を触媒重合して、導電ネットワ ークを形成できた。また、重合性基としてアセチレン 基、ジアセチレン基等のビーム照射重合性基を有する有 機分子の集合群からなる単分子膜又は単分子累積膜に、 紫外線、遠紫外線、電子線又はX線等のエネルギービー ムを照射して、有機分子相互を重合し導電ネットワーク を形成できた。

【0191】(実施例4)上記実施例1と同様の方法 で、複数の3端子有機電子デバイスを液晶の動作スイッ チとしてアクリル基板表面に配列配置してアレイ基板を 作製し、さらにその表面に配向膜を作製した。次に、ス クリーン印刷法を用いてシール接着剤を封口部を除いて バターン形成した後、プレキュアーしてカラーフィルタ ー基板の配向膜面を向かい合わせにし、貼り合わせて圧 着し前記パターン形成された接着剤を硬化させて、空セ ルを作製した。最後に、空セルに所定の液晶を真空注入 した後、液晶を封止することにより液晶表示装置を製造 できた。ここで、基板上に3端子有機電子デバイスを形 成してTFTアレイ基板を作製すること以外は、公知技 術を利用した。

【0192】この方法では、TFTアレイの製造におい て、基板加熱の必要がないので、アクリル基板のような 質なTFT型液晶表示装置が製造できた。

【0193】(実施例5)上記実施例1と同様の方法で、複数の3端子有機電子デバイスを液晶の動作スイッチとしてアクリル基板表面に配列配置してTFTアレイ基板を作製した。その後、公知の方法を用いて前記3端子有機電子デバイスのに接続される画素電極を形成し、TFTアレイ基板上に電界が印加されると発光する蛍光物質からなる発光層を形成し、TFTアレイ基板に対向する透明共通電極を発光層上に形成して、エレクトロルミネッセンス型カラー表示装置を製造できた。ことで、基板上に3端子有機電子デバイスを形成してアレイ基板を形成すること以外は、公知技術を利用した。

37

【0194】発光層を形成する際、赤、青、緑色の光を発光する3種類の素子をそれぞれ所定の位置に形成することにより、エレクトロルミネッセンス型カラー表示装置が製造できた。各色要素の配列は公知技術を利用した。

【0196】このようにして得られた有機薄膜の表面を覆うように絶縁膜を形成することにより電気ケーブルを作製した。得られた電線の断面図を図13に示す。図13において、50は電気ケーブル、51はガラス芯線、52はポリビロール電解酸化重合膜、53は室温硬化型のシリコーンゴムからなる被覆絶縁膜である。

【0197】この電気ケーブルの電導度 ρ はドープなし $\tau_{\rho}>1\times10^7$ S/cmであり、「超金属導電膜」で あることが確認できた。電導度の測定は実施例1と同じ 40 方法で行った。

【0198】本実施例においては、前記電気ケーブルは 互いに電気的に絶縁された複数の芯線で形成され、集合 電線を形成していてもよい。

【0199】また、電線を作成する場合の芯線は、ガラス以外にも金属も使用することができる。金属の場合は、表面に酸化物を形成すると、単分子膜は形成しやすい。

【 0 2 0 0 】 (実施例7) 前記実施例1~5 において、 ロジェット法を用いて形成された累積膜であり、各単分 導電性分子が配向しているか否かは、図14 に示すよう 50 子層の配向方向が同一方向であるY型導電性単分子累積

な液晶セル60を形成し、偏光板67,68で挟み、裏 面より光を照射して70の位置から観察することにより 確認できる。液晶セル60は、導電性分子膜62、64 がそれぞれ形成されたガラス板61、63を導電性分子 膜を内側にして、ギャップ間距離5~6μmに保持して 周囲を接着剤65で封止し、内部に液晶組成物66(ネ マチック液晶、例えばチッソ社製"LC、MT-508 7 L A") を注入して作成する。(1) 偏光板67.6 8をクロスにした場合、導電性分子膜62、64の配向 方向を揃え、この方向と、一方の偏光板を平行にし、他 方の偏光板を直交させる。完全に配向していれば液晶が 配向して均一な黒色になる。均一な黒色にならない場合 は配向不良である。(2) 偏光板67,68を平行にし た場合、導電性分子膜62、64の配向方向を揃え、こ の方向と、両方の偏光板を平行にする。完全に配向して いれば液晶が配向して均一な白色になる。均一な白色に ならない場合は配向不良である。

【0201】なお、裏側の基板が透明でない場合は、偏 光板は上側一枚とし、表面より光を照射して反射光で観 窓する

【0202】この方法により、前記実施例1~5で得られた導電性分子膜は配向していることが確認できた。 【0203】

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、従来の有機導電膜よりも高い導電性を有するか、または金や銀などの導電性金属と同等かまたはそれ以上の導電性を有する導電性有機薄膜とその製造方法を提供できる。

【0204】次に本発明は、デバイスの高密化が進展し 0.1 μ m以下の微細加工がなされても、結晶性に左右 されない有機物質を用いたデバイスを作製することによ り高集積化されたデバイスを提供できる。また、プラス チック基板等に形成することにより、フレキシビリティ ーに優れた有機電子デバイスを提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】Aは本発明の実施の形態1における基材上に形成された導電性単分子膜を分子レベルにまで拡大した概念断面図であり、Bはその平面図である。

【図2】本発明の実施の形態1におけるラビング配向法を説明するための概念図である。

【図3】本発明の実施の形態1における光配向法を説明 するための概念図である。

【図4】本発明の実施の形態1における引き上げ配向法 を説明するための概念図である。

【図5】A-Dは本発明の実施の形態3における単分子 累積膜の構造例を示す分子レベルまで拡大した概念図で あり、Aは化学吸着法を用いた累積膜を示し、各単分子 層の配向方向が同一方向であるX型導電性単分子累積膜 の断面図であり、Bは2層目以降がラングミュアーーブ ロジェット法を用いて形成された累積膜であり、各単分 子層の配向方向が同一方向であるY型導電性単分子累積

2.

【図13】

膜の断面図であり、Cは各単分子層でとに配向方向が異なるX型導電性単分子累積膜の断面図であり、Dは各単分子層でとに2つの配向方向のいずれかに配向したX型 導電性単分子累積膜の断面図である。

【図6】A-Bは本発明の実施の形態4における3端子有機電子デバイスの構造を分子レベルまで拡大した概念図であり、Aは第1と第2の電極が絶縁膜付き基板表面に形成された構造の断面図、Bは第1と第2の電極が有機薄膜表面に形成された構造の断面図である。

【図7】A-Bは本発明の実施の形態4における印加電 10 界に対する3端子有機電子デバイスの導電性の変化を説明する概念図であり、Aは導電ネットワークの導電率と第3の電極に印加された電圧との依存性を説明する概念図、Bは第3の電極への電圧印加の有無によるスイッチング動作を説明する概念図である。

【図8】本発明の実施例1の第3電極形成工程を説明するための第3の電極を形成した基板を拡大した概念断面図である。

【図9】本発明の実施例1における成膜工程を説明する ための単分子膜を形成した基板を分子レベルまで拡大し 20 た概念断面図である。

【図10】は本発明の実施例1における配向した単分子 膜を形成した基板を分子レベルまで拡大した概念断面図 である。

【図11】本発明の実施例1における対電極形成工程及び導電ネットワーク形成工程を説明するための導電ネットワークを形成し、かつ第1の電極と第2の電極とを形成した基板を分子レベルまで拡大した概念断面図である。

【図12】本発明の実施の形態1における有機分子の傾 30 斜方向を説明するための概念斜視図である。

【図13】本発明の実施例6で得られた電気ケーブルの概念断面図である。

【図14】本発明の実施例7における導電性分子の配向 を評価する方法を示す説明図。

【図15】本発明の実施例1で得られたピロリル化合物のNMRのチャートである。 :

}重合性基 }有極性の官能基 *【図16】本発明の実施例1で得られたピロリル化合物 のIRのチャートである。

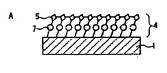
【図17】本発明の実施例2で得られたチェニル化合物のNMRのチャートである。

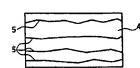
【図18】本発明の実施例2で得られたチェニル化合物の IRのチャートである。

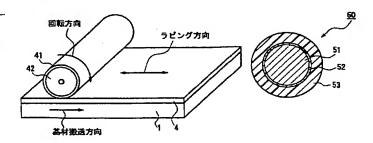
【符号の説明】

- 1 基板
- 4 導電性単分子膜
- 10 5 導電ネットワーク
 - 7 活性水素を含まない有極性官能基
 - 11 基板
 - 12 第1の電極
 - 13 第2の電極
 - 14 電界応答型導電性単分子膜
 - 15 導電ネットワーク
 - 17 第3の電極
 - 18 第1の絶縁膜
 - 19 第2の絶縁膜
 - o 31 ポリイミド基板
 - 34 電界応答型単分子膜
 - 34a 単分子膜
 - 34b 配向した単分子膜
 - 34c 導電性単分子膜
 - 35 導電ネットワーク
 - 37 アルミ製の第3の電極
 - 38 シリカ膜
 - 39 アルミナ膜
 - 41 ラビング布
- 30 42 ラビングロール
 - 43 偏光板
 - 4.4 有機溶媒
 - 50 電気ケーブル
- 51 ガラス芯線
 - 52 ポリピロール電解酸化重合膜
 - 53 被覆絶縁膜
 - 60 液晶セル

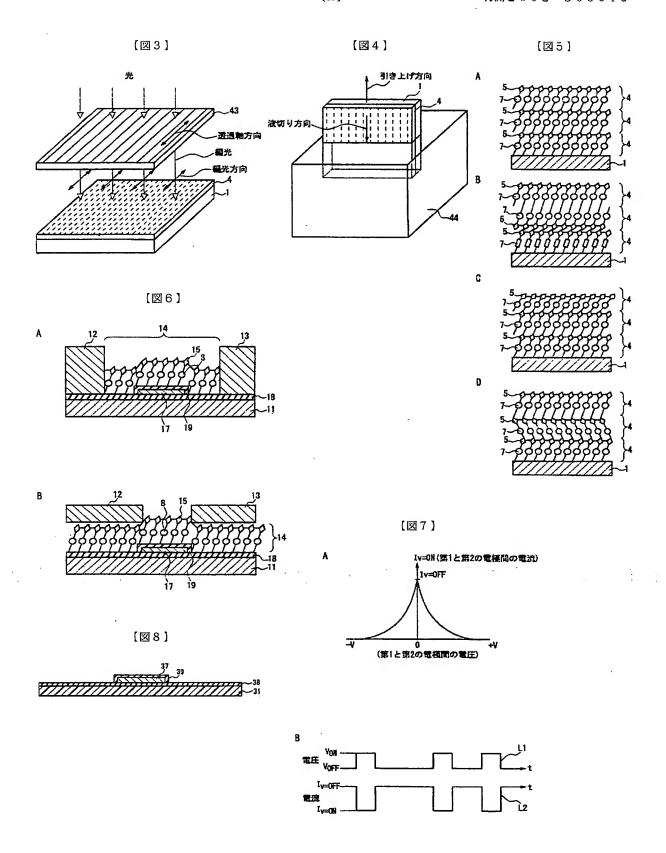
[図1] 【図2】







40

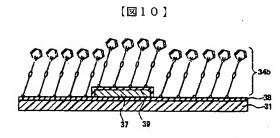


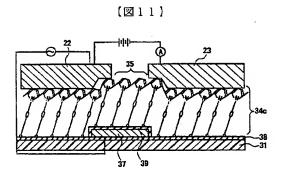
(図9)

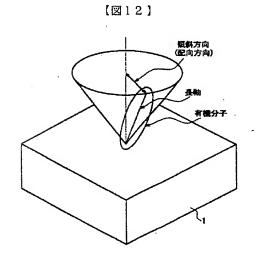
CHUH-(CH)-1-000-(CH)-10-Si (-0-)-1を

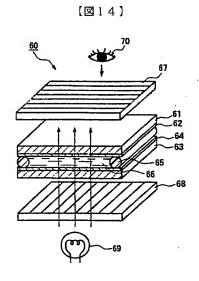
CHUH-(CH)-10-Si (-0-)-10-Si (-0-)-10-Si (-0-)-1を

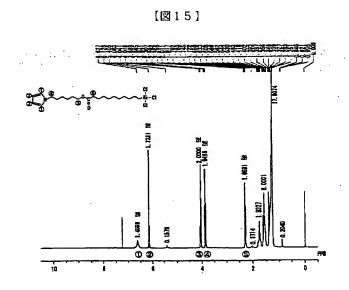
CHUH-(CH)-10-Si (-0-)-10-Si (



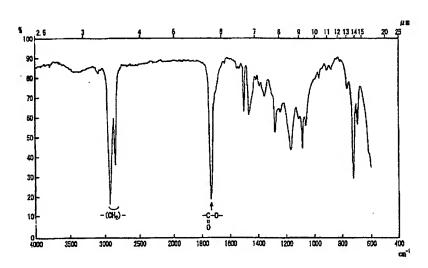




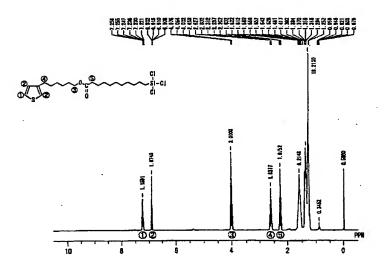




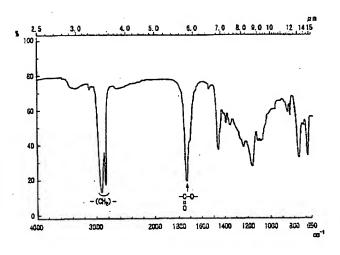
[図16]



【図17】



【図18】



【手続補正書】

【提出日】平成14年1月4日(2002.1.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項21

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項21】 前記有機分子が下記化学式(3)または(4)で示される請求項15に記載の導電性有機薄膜の製造方法。

[113]

$$X - (CH_2) = Z - (CH_2) = SiD_p E_1 - (CH_2) = Si$$

{{t4}}

(但し、前記式(3)及び(4)において、Xは水素、または不飽和基を含む有機基、qは0~10の整数、Zはエステル基(-COO-)、オキシカルボニル基(-OCO-)、カルボニル基(-CO-)またはカーボネイト(-OCOO-)基、Dはハロゲン原子、イソシアネート基又は炭素数1-3のアルコキシル基、Eは水素または炭素数1-3のアルキル基、m、nは整数でありm+nは2以上25以下、好ましくは10以上20以下の整数、pは整数であり、1、2又は3である。)

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項38

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項38】 下記化学式(5)または(6)で示されるビロリル化合物またはチェニル化合物。 【化5】

$$X - (CH_2) = Z - (CH_2) = Z - (CH_2) = SiD_{p} E_3 - CH_2$$

[{£6]

(但し、前記式(5)及び(6)において、Xは水素、または不飽和基を含む有機基、qは0~10の整数、Zはエステル基(-COO-)、オキシカルボニル基(-COO-)またはカーボネイト(-OCOO-)基、Dはハロゲン原子、イソシアネート基又は炭素数1-3のアルコキシル基、Eは水素または炭素数1-3のアルキル基、m、nは整数でありm+nは2以上25以下、好ましくは10以上20以下の整数、pは整数であり、1、2又は3である。)

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正内容】

[0020]

(1t9)

$$X - (CH_2) = Z - (CH_2) = Z - (CH_2) = SiD_pE$$

[1210]

$$X - (CH_2) \frac{1}{a} \left(CH_2 \right) \frac{1}{a} Z - (CH_2) \frac{1}{a} SiD_p E_2 \rightarrow$$

【手続補正4】 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0035 【補正方法】変更 【補正内容】

*【0035】(但し、前記式(11)及び(12)にお いて、Xは水素、または不飽和基を含む有機基、qは0 ~10の整数、Zはエステル基 (-COO-)、オキシ カルボニル基(-000-)、カルボニル基(-00 -) またはカーボネイト (-OCOO-) 基、Eは水素 または炭素数1-3のアルキル基、m、nは整数であり m+nは2以上25以下、好ましくは10以上20以下 の整数、pは整数であり、1、2又は3である。) 本発明で用いる材料分子の末端官能基は、クロロシリル 基、アルコシリル基またはイソシアネート基であり、基 材表面の活性水素と脱塩化水素反応、脱アルコール反応 及び脱イソシアネート基から選ばれる少なくとも一つの 脱離反応によって共有結合を形成することが好ましい。

フ	ン	F	ベ	_	35	മ	结	李

(51)Int.Cl.'		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
H01B	1/12		H01B	1/12	E	5G309
					Z	
	7/02			7/02	Z	
	13/00	5 0 1		13/00	501Z	
H01L	21/28	3 0 1	H01L	21/28	301Z	
	21/283	•		21/283	Z	
	29/786		C 0 8 L 101:00			
	51/00		H01L	29/28		
// C08L	101:00			29/78	618B	

(72)発明者 山本 伸一

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

Fターム(参考) 2H092 JA24 JB11 JB31 KA20 NA29 PA08

> 4F071 AA38 AA58 AA61 AA80 AB02 AB03 AB04 AF37 AH12 BA02 BB12 BC02

> 4M104 AA10 BB02 BB05 BB36 CC01

CC05 DD77 EE03 EE16 GG09

5C094 BA03 BA27 BA43 CA19 CA24

DA13 ED03 FA01 FB01 FB12

JA05

5F110 AA30 BB01 CC03 CC07 DD01

· DD02 EE03 FF01 FF24 GG05

GG41 GG58 HK02

5G309 RA15